

14. 7. 2004

日本国特許庁 JAPAN PATENT OFFICE

REC'D 02 SEP 2004

別紙添付の書類に記載されている事項は下記のW順空類に記載PSTでいる事項と同一であることを証明する。

This is to certify that the annexed is a true copy of the following application as filed with this Office.

出願年月日 Date of Application:

2003年12月24日

出 願 番 号 Application Number:

特願2003-426226

[ST. 10/C]:

[JP2003-426226]

出 願 人
Applicant(s):

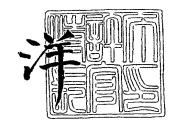
日産化学工業株式会社

PRIORITY DOCUMENT

SUBMITTED OR TRANSMITTED IN COMPLIANCE WITH RULE 17:1 (a) OR (b)

特許庁長官 Commissioner, Japan Patent Office 2004年 8月20日

ふ 門



1/E



【書類名】 特許願 【整理番号】 4643000

【提出日】平成15年12月24日【あて先】特許庁長官 殿【国際特許分類】B01J 31/24

【発明者】

【住所又は居所】 千葉県千葉市稲毛区弥生町1-33

【氏名】 濱田 康正

【発明者】

【住所又は居所】 千葉市稲毛区穴川3-11-78 ハイムシイナ107

【氏名】 牧野 一石

【特許出願人】

【識別番号】 000003986

【氏名又は名称】 日産化学工業株式会社

【代表者】藤本 修一郎【電話番号】047-465-1120

【先の出願に基づく優先権主張】

【出願番号】 特願2003-272637 【出願日】 平成15年 7月10日

【手数料の表示】

【予納台帳番号】 005212 【納付金額】 21,000円

【提出物件の目録】

【物件名】 特許請求の範囲 1

 【物件名】
 明細書 1

 【物件名】
 要約書 1



【書類名】特許請求の範囲

【請求項1】

式(1)

【化1】

「式中、R1は、C1-20アルキル基(該C1-20アルキル基はC4-12 芳香族基(該芳香族基は 、ハロゲン原子、 C_{1-6} アルキル基、 C_{1-6} アルコキシ基、 C_{1-6} アルコキシカルボニル基、 C_1 -6アルキルカルボニルオキシ基又はCONR⁴R⁵(式中、R⁴及びR⁵は、それぞれ独立して、水 素原子又はC1-6アルキル基を意味する。)で任意に置換されていてもよい。)、C1-6アル コキシ基、 C_{1-6} アルコキシカルボニル基又は $CONR^4R^5$ (式中、 R^4 及び R^5 は、それぞれ独立 して、水素原子又はC1-6アルキル基を意味する。)で任意に置換されていてもよい。)又 はC4-12 芳香族基(該芳香族基は、ハロゲン原子、C1-6アルキル基、C1-6アルコキシ基 、C₁₋₆アルコキシカルボニル基、C₁₋₆アルキルカルボニルオキシ基(該C₁₋₆アルキル基、 C1-6アルコキシ基、C1-6アルコキシカルボニル基及びC1-6アルキルカルボニルオキシ基は 、C4-12 芳香族基(該芳香族基は、ハロゲン原子で任意に置換されていてもよい。)で 任意に置換されていてもよい。)又は $CONR^4R^5$ (式中、 R^4 及び R^5 は、それぞれ独立して、 水素原子又はC1-6アルキル基を意味する。)で任意に置換されていてもよい。)を意味し 、R²は、C₁₋₂₀アルキル基(該C₁₋₂₀アルキル基はC₄₋₁₂ 芳香族基(該芳香族基は、ハロ ゲン原子、C1-6アルキル基、C1-6アルコキシ基、C1-6アルコキシカルボニル基、C1-6アル キルカルボニルオキシ基又は $CONR^4R^5$ (式中、 R^4 及 UR^5 は、それぞれ独立して、水素原子 又はC1-6アルキル基を意味する。)で任意に置換されていてもよい。)、C1-6アルコキシ 基、 C_{1-6} アルコキシカルボニル基又は $CONR^4R^5$ (式中、 R^4 及び R^5 は、それぞれ独立して、 水素原子又はC1-6アルキル基を意味する。)で任意に置換されていてもよい。)又はC4-12 芳香族基(該芳香族基は、ハロゲン原子、C1-6アルキル基、C1-6アルコキシ基、C1-6 アルコキシカルボニル基、C1-6アルキルカルボニルオキシ基又はCONR⁴R⁵(式中、R⁴及びR ⁵は、それぞれ独立して、水素原子又はC₁₋₆アルキル基を意味する。)で任意に置換され ていてもよい。)を意味する。]で表されるα-アミノアシル酢酸エステル化合物を、酸 の存在下、触媒的不斉水素化反応により水素化することを特徴とする、式 (2) 又は式 (

【化2】

[式中、 R^1 及び R^2 は、前記と同じ意味を示す。] で表される光学活性 β - ヒドロキシー α - アミノカルボン酸誘導体の製造方法。

【請求項2】

触媒的不斉水素化反応に使用される触媒が、光学活性ホスフィン配位子を有する、周期表第VIII族の遷移金属錯体である請求項1記載の光学活性 $\beta-$ ビドロキシー $\alpha-$ アミノカルボン酸誘導体の製造方法。

【請求項3】

周期表第VIII族の遷移金属がルテニウム、イリジウム又はロジウムであり、光学活性ホスフィン配位子が光学活性 2 座ホスフィン配位子である請求項 2 記載の光学活性 β ーヒドロキシー α - アミノカルボン酸誘導体の製造方法。

【請求項4】

周期表第VIII族の遷移金属がルテニウムであり、光学活性2座ホスフィン配位子が式(4)



【化3】

(式中、 R^3 は、水素原子、メチル基又は三級ブチル基を意味し、絶対配置はS又はRのどちらかを意味する。)である請求項3記載の光学活性 β ーヒドロキシー α ーアミノカルボン酸誘導体の製造方法。

【請求項5】

遷移金属錯体がRuHX¹ (R³-BINAP)2、RuX²2 (R³-BINAP)又はRu2Cl4 (R³-BINAP)2 (Et3N) (式中、R³-BINAPは式 (4) で表される光学活性2座ホスフィン配位子を意味し、X¹及びX²は、それぞれCl、Cl04、BF4、PF6、OCOCH3、OCOCF3、OCO-t-Bu又はOSO2CF3を意味するが、該錯体は、N,N-ジメチルホルムアミド、ベンゼン、AlCl3、SnCl4、TiCl4又はZnCl2で更に配位されていてもよい。)である請求項4記載の光学活性 β -ヒドロキシー α -アミノカルボン酸誘導体の製造方法。

【請求項6】

遷移金属錯体が RuX^2_2 (R^3 –BINAP) (式中、 X^2 及び R^3 –BINAPは前記と同様であり、該錯体は、N, N–ジメチルホルムアミド、ベンゼン、 $A1Cl_3$ 、 $SnCl_4$ 、 $TiCl_4$ 又は $ZnCl_2$ で更に配位されていてもよい。)である請求項 5 記載の光学活性 β – ヒドロキシー α – アミノカルボン酸誘導体の製造方法。

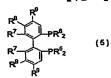
【請求項7】

 X^2 がC1であり、N, N-ジメチルホルムアミド又はベンゼンで更に配位された RuX^2 ₂ (R^3 –BINAP)を用いる請求項 6 に記載の光学活性 β – ヒドロキシー α – アミノカルボン酸誘導体の製造方法。

【請求項8】

周期表第VIII族の遷移金属がイリジウムであり、光学活性 2 座ホスフィン配位子が \mathbb{R}^3 -BIN AP(\mathbb{R}^3 -BINAPは、前記と同じ意味を表す。)又は式(5)

【化4】



(式中、 R^6 は、フェニル基、ナフチル基(該フェニル基及びナフチル基は C_{1-6} アルキル基又は C_{1-6} アルコキシ基で任意に置換されていてもよい。)、シクロペンチル基又はシクロヘキシル基を意味し、 R^7 は、メチル基又はメトキシ基を意味し、 R^8 は、水素原子、メチル基、メトキシ基又は塩素原子を意味し、 R^9 は、水素原子、メチル基、メトキシ基、ジメチルアミノ基又ジエチルアミノ基を意味し、絶対配置はS 又はR のどちらかを意味する。)で表される化合物である請求項3記載の光学活性 β ーヒドロキシー α ーアミノカルボン酸誘導体の製造方法。

【請求項9】

反応系中に酢酸塩を加える請求項8記載の光学活性 β ーヒドロキシー α ーアミノカルボン酸誘導体の製造方法。

【請求項10】

遷移金属錯体を調製する際、ヨウ素化合物を添加する請求項 9 記載の光学活性 β ーヒドロキシー α ーアミノカルボン酸誘導体の製造方法。

【請求項11】



光学活性 2 座ホスフィン配位子が式(5)で表される化合物である請求項 1 0 記載の光学活性 β – ヒドロキシー α – アミノカルボン酸誘導体の製造方法。

【請求項12】

遷移金属錯体を調製する際、 $[Ir(cod)Cl]_2$ (式中、codは、1,5-シクロオクタジエンを意味する。)を使用する請求項11記載の光学活性 β -ヒドロキシー α -アミノカルボン酸誘導体の製造方法。

【請求項13】

酸が強酸である請求項 $1\sim 1$ 2 の何れかに記載の光学活性 β ーヒドロキシー α ーアミノカルボン酸誘導体の製造方法。



【書類名】明細書

【発明の名称】光学活性 β ーヒドロキシー α ーアミノカルボン酸誘導体の製造方法 【技術分野】

[0001]

本発明は、医・農薬の中間体として有用である光学活性 β ーヒドロキシー α ーアミノカルボン酸誘導体の製造方法に関するものである。

【背景技術】

[0002]

光学活性 β ーヒドロキシー α ーアミノカルボン酸誘導体は、医・農薬等の生理活性物質をはじめとする、種々のファインケミカルで有用な化合物の重要な中間体である。

[0003]

光学活性 β ーヒドロキシー α ーアミノカルボン酸誘導体を製造する方法としては、ルテニウムー光学活性ホスフィン錯体触媒を用いる触媒的不斉水素化反応により、ラセミの α ーアミノアシル酢酸エステル化合物を不斉水素化し、シン選択的に光学活性 β ーヒドロキシー α ーアミノカルボン酸誘導体を製造する方法が知られていた(例えば非特許文献 1 及び 2 並びに特許文献 1 参照。)。

[0004]

一方、オレフィン、ケトン及びイミン類の遷移金属触媒による不斉水素化反応はよく知られていた。 (例えば非特許文献3参照。)。

【特許文献1】特開平06-80617号公報

【非特許文献1】J.Am.Chem.Soc.,1989,111, p.9134-9135

【非特許文献 2】 SYNTHESIS, 1992, p. 1248-1254

【非特許文献 3】 R. Noyori ed. Asymmetric Catalysis in Organic Synthesis, (1994) Jhon Wiley&; Sons, Inc, New York

【発明の開示】

【発明が解決しようとする課題】

[0005]

非特許文献1及び2並びに特許文献1に記載の方法は、光学活性β-ヒドロキシーα-アミノカルボン酸誘導体のシン体を選択的に製造する方法としては優れているものである

[0006]

しかし、逆に光学活性 β ーヒドロキシー α ーアミノカルボン酸誘導体のアンチ体を直接製造することはできないため、アンチ体を製造するためには、一旦シン体を製造し、一方の立体を反転させなければならなかった。

[0007]

そのため、直接光学活性 β ーヒドロキシー α ーアミノカルボン酸誘導体のアンチ体を製造する方法が望まれていた。

【課題を解決するための手段】

[0008]

本発明者らは、直接光学活性 β ーヒドロキシー α ーアミノカルボン酸誘導体のアンチ体を製造する方法について鋭意検討を重ねた結果、アミノ基が無置換である α ーアミノアシル酢酸エステル化合物を、酸の存在下、触媒的不斉水素化反応により水素化することにより容易にアンチ体の光学活性 β ーヒドロキシー α ーアミノカルボン酸誘導体が選択的に得られることを見出し、本発明を完成させた。

[0009]

即ち、本発明は、

1. 式(1)

[0010]



【化1】

$$\begin{array}{c}
0 \\
R^1 \\
\downarrow CO_2R^2
\end{array}$$
(1)

[0011]

[式中、R1は、C1-20アルキル基(該C1-20アルキル基はC4-12 芳香族基(該芳香族基は 、ハロゲン原子、C1-6アルキル基、C1-6アルコキシ基、C1-6アルコキシカルボニル基、C1 -6アルキルカルボニルオキシ基又はCONR⁴R⁵(式中、R⁴及びR⁵は、それぞれ独立して、水 素原子又はC1-6アルキル基を意味する。)で任意に置換されていてもよい。)、C1-6アル コキシ基、 C_{1-6} アルコキシカルボニル基又は $CONR^4R^5$ (式中、 R^4 及び R^5 は、それぞれ独立 して、水素原子又はC1-6アルキル基を意味する。) で任意に置換されていてもよい。) 又 はC4-12 芳香族基(該芳香族基は、ハロゲン原子、C1-6アルキル基、C1-6アルコキシ基 、C₁₋₆アルコキシカルボニル基、C₁₋₆アルキルカルボニルオキシ基(該C₁₋₆アルキル基、 C_{1-6} アルコキシ基、 C_{1-6} アルコキシカルボニル基及び C_{1-6} アルキルカルボニルオキシ基は 、C4-12 芳香族基(該芳香族基は、ハロゲン原子で任意に置換されていてもよい。)で 任意に置換されていてもよい。)又は $CONR^4R^5$ (式中、 R^4 及 UR^5 は、それぞれ独立して、 水素原子又はC1-6アルキル基を意味する。)で任意に置換されていてもよい。)を意味し 、 R^2 は、 C_{1-20} アルキル基(該 C_{1-20} アルキル基は C_{4-12} 芳香族基(該芳香族基は、ハロ ゲン原子、C1-6アルキル基、C1-6アルコキシ基、C1-6アルコキシカルボニル基、C1-6アル キルカルボニルオキシ基又は $CONR^4R^5$ (式中、 R^4 及 UR^5 は、それぞれ独立して、水素原子 又はC1-6アルキル基を意味する。)で任意に置換されていてもよい。)、C1-6アルコキシ 基、 C_{1-6} アルコキシカルボニル基又は $CONR^4R^5$ (式中、 R^4 及び R^5 は、それぞれ独立して、 水素原子又はC1-6アルキル基を意味する。)で任意に置換されていてもよい。)又はC4-12 芳香族基(該芳香族基は、ハロゲン原子、C1-6アルキル基、C1-6アルコキシ基、C1-6 アルコキシカルボニル基、C₁₋₆アルキルカルボニルオキシ基又はCONR⁴R⁵ (式中、R⁴及びR ⁵は、それぞれ独立して、水素原子又はC1-6アルキル基を意味する。)で任意に置換され ていてもよい。)を意味する。]で表されるα-アミノアシル酢酸エステル化合物を、酸 の存在下、触媒的不斉水素化反応により水素化することを特徴とする、式(2)又は式(3)

【化2】

[0013]

[式中、 R^1 及び R^2 は、前記と同じ意味を示す。] で表される光学活性 β ーヒドロキシー α ーアミノカルボン酸誘導体の製造方法。

[0014]

2. 触媒的不斉水素化反応に使用される触媒が、光学活性ホスフィン配位子を有する、 周期表第VIII族の遷移金属錯体である 1. 記載の光学活性 β ーヒドロキシー α ーアミノカルボン酸誘導体の製造方法。

[0015]

3. 周期表第VIII族の遷移金属がルテニウム、イリジウム又はロジウムであり、光学活性ホスフィン配位子が光学活性 2 座ホスフィン配位子である 2. 記載の光学活性 β ーヒドロキシー α ーアミノカルボン酸誘導体の製造方法。

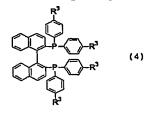
[0016]

4. 周期表第VIII族の遷移金属がルテニウムであり、光学活性2座ホスフィン配位子が式(4)

[0017]



【化3】



[0018]

(式中、 R^3 は、水素原子、メチル基又は三級プチル基を意味し、絶対配置はS又はRのどちらかを意味する。)である3. 記載の光学活性 β – ヒドロキシー α – アミノカルボン酸誘導体の製造方法。

[0019]

5. 遷移金属錯体がRuHX 1 (R 3 -BINAP) $_2$ 、RuX 2 $_2$ (R 3 -BINAP)又はRu $_2$ Cl $_4$ (R 3 -BINAP) $_2$ (Et $_3$ N) (式中、R 3 -BINAPは式(4)で表される光学活性2座ホスフィン配位子を意味し、X 1 及び X 2 は、それぞれC1、ClO $_4$ 、BF $_4$ 、PF $_6$ 、OCOCH $_3$ 、OCOCF $_3$ 、OCO-t-Bu又はOSO $_2$ CF $_3$ を意味するが、該錯体は、N,N-ジメチルホルムアミド、ベンゼン、AlCl $_3$ 、SnCl $_4$ 、TiCl $_4$ 又はZnCl $_2$ で更に配位されていてもよい。)である4. 記載の光学活性 β -ヒドロキシー α -アミノカルボン酸誘導体の製造方法。

[0020]

6. 遷移金属錯体が RuX^2_2 (R^3 -BINAP) (式中、 X^2 及び R^3 -BINAPは前記と同様であり、該錯体は、N,N-ジメチルホルムアミド、ベンゼン、 $A1Cl_3$ 、 $SnCl_4$ 、 $TiCl_4$ 又は $ZnCl_2$ で更に配位されていてもよい。) である 5. 記載の光学活性 β - ヒドロキシー α - アミノカルボン酸誘導体の製造方法。

[0021]

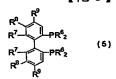
7. X^2 がC1であり、N, N-ジメチルホルムアミド又はベンゼンで更に配位された RuX^2_2 (R^3 –BINAP)を用いる 6. に記載の光学活性 β –ヒドロキシー α –アミノカルボン酸誘導体の製造方法。

[0022]

8. 周期表第VIII族の遷移金属がイリジウムであり、光学活性 2 座ホスフィン配位子が R^3 -BINAP (R^3 -BINAPは、前記と同じ意味を表す。)又は式(5)

[0023]

【化4】



[0024]

(式中、 R^6 は、フェニル基、ナフチル基(該フェニル基及びナフチル基は C_{1-6} アルキル基又は C_{1-6} アルコキシ基で任意に置換されていてもよい。)、シクロペンチル基又はシクロヘキシル基を意味し、 R^7 は、メチル基又はメトキシ基を意味し、 R^8 は、水素原子、メチル基、メトキシ基又は塩素原子を意味し、 R^9 は、水素原子、メチル基、メトキシ基、ジメチルアミノ基又ジエチルアミノ基を意味し、絶対配置はS又はRのどちらかを意味する。)で表される化合物である3. 記載の光学活性 β -ヒドロキシー α -アミノカルボン酸誘導体の製造方法。

[0025]

9. 反応系中に酢酸塩を加える 8. 記載の光学活性 β ーヒドロキシー α ーアミノカルボン酸誘導体の製造方法。

[0026]

10. 遷移金属錯体を調製する際、ヨウ素化合物を添加する 9. 記載の光学活性 β ーヒ ドロキシー α ーアミノカルボン酸誘導体の製造方法。



[0027]

11. 光学活性 2 座ホスフィン配位子が式(5)で表される化合物である 10. 記載の 光学活性 β - ヒドロキシー α - アミノカルボン酸誘導体の製造方法。

[0028]

12. 遷移金属錯体を調製する際、 $[Ir(cod)Cl]_2$ (式中、 $codは、1,5-シクロオクタジェンを意味する。)を使用する11. 記載の光学活性 <math>\beta$ – ヒドロキシー α – アミノカルボン酸誘導体の製造方法。

[0029]

13. 酸が強酸である $1. \sim 12$. の何れかに記載の光学活性 β - \forall β - β - - β - β

に関するものである。

[0030]

以下、更に詳細に本発明を説明する。

[0031]

尚、本発明中「n」はノルマルを「i」はイソを「s」はセカンダリーを「t」はターシャリーを「c」はシクロを「o」はオルトを「m」はメタを「p」はパラを意味する。

[0032]

まず、置換基 R^1 及び R^2 の各置換基における語句について説明する。

[0033]

ハロゲン原子としては、フッ素、塩素、臭素及びヨウ素が挙げられる。

[0034]

С1-6アルキル基としては、直鎖、分枝及びС3-6シクロアルキル基を含んでいて もよく、メチル、エチル、n-プロピル、i-プロピル、c-プロピル、n-ブチル、i-ブチル、 s-ブチル、t-ブチル、c-ブチル、1-メチル-c-プロピル、2-メチル-c-プロピル、n-ペンチ ル、1-メチル-n-ブチル、2-メチル-n-ブチル、3-メチル-n-ブチル、1,1-ジメチル-n-プロ ピル、1,2-ジメチル-n-プロピル、2,2-ジメチル-n-プロピル、1-エチル-n-プロピル、c-ペンチル、1-メチル-c-ブチル、2-メチル-c-ブチル、3-メチル-c-ブチル、1,2-ジメチルc-プロピル、2, 3-ジメチル-c-プロピル、1-エチル-c-プロピル、2-エチル-c-プロピル、n-ヘキシル、1-メチル-n-ペンチル、2-メチル-n-ペンチル、3-メチル-n-ペンチル、4-メチ ·ル-n-ペンチル、1,1-ジメチル-n-ブチル、1,2-ジメチル-n-ブチル、1,3-ジメチル-n-ブチ ル、2,2-ジメチル-n-ブチル、2,3-ジメチル-n-ブチル、3,3-ジメチル-n-ブチル、1-エチ ν_{-n} -ブチル、2-エチル-n-ブチル、1,1,2-トリメチル-n-プロピル、1,2,2-トリメチル-n-プロピル、1-エチル-1-メチル-n-プロピル、1-エチル-2-メチル-n-プロピル、c-ヘキシル 、1-メチル-c-ペンチル、2-メチル-c-ペンチル、3-メチル-c-ペンチル、1-エチル-c-プチ ル、2-エチル-c-プチル、3-エチル-c-ブチル、1,2-ジメチル-c-ブチル、1,3-ジメチル-c-ブチル、2,2-ジメチル-c-プチル、2,3-ジメチル-c-ブチル、2,4-ジメチル-c-ブチル、3,3 _ジメチル-c-プチル、1-n-プロピル-c-プロピル、2-n-プロピル-c-プロピル、1-i-プロピ ル-c-プロピル、2-i-プロピル-c-プロピル、1,2,2-トリメチル-c-プロピル、1,2,3-トリ メチル-c-プロピル、2,2,3-トリメチル-c-プロピル、1-エチル-2-メチル-c-プロピル、2-エチル-1-メチル-c-プロピル、2-エチル-2-メチル-c-プロピル及び2-エチル-3-メチル-c-プロピル等が挙げられる。

[0035]

 C_{1-20} アルキル基としては直鎖、分枝及び C_{3-20} シクロアルキル基を含んでいてもよく、上記に加え、1-メチル-1-エチル-n-ペンチル、1-ヘプチル、2-ヘプチル、c-ヘプチル、1-エチル-1, 2-ジメチル-n-プロピル、1-エチル-2, 2-ジメチル-n-プロピル、1-エチル-2, 2-ジメチル-n-プロピル、1-オクチル、3-オクチル、2-プロピル-1-n-ヘプチル、2, 4, 4-トリメチル-1-n-ペンチル、1-ノニル、2-ノニル、2, 6-ジメチル-4-n-ヘプチル、3-エチル-2, 2-ジメチル-3-n-ペンチル、3, 5-トリメチル-1-n-ヘキシル、1-デシル、2-デシル、4-デシル、3, 7-



ジメチルー1-n-オクチル、3, 7-ジメチルー3-n-オクチル、n-ウンデシル、n-ドデシル、n-トリデシル、n-テトラデシル、n-ペンタデシル、n-ヘキサデシル、n-ヘプタデシル、n-オクタデシル、n-メナデシル及びn-エイコシル等が挙げられる。

[0036]

С1-6 アルコキシ基としては、直鎖、分枝及びС3-6 シクロアルコキシ基を含んで いてもよく、メトキシ、エトキシ、n-プロポキシ、i-プロポキシ、c-プロポキシ、n-ブト キシ、i-ブトキシ、s-プトキシ、t-ブトキシ、c-ブトキシ、1-メチル-c-プロポキシ、2-メチル-c-プロポキシ、n-ペンチルオキシ、1-メチル-n-ブトキシ、2-メチル-n-ブトキシ 、3-メチル-n-ブトキシ、1,1-ジメチル-n-プロポキシ、1,2-ジメチル-n-プロポキシ、2,2 _ジメチル-n-プロポキシ、1-エチル-n-プロポキシ、c-ペンチルオキシ、1-メチル-c-ブト キシ、2-メチル-c-ブトキシ、3-メチル-c-ブトキシ、1,2-ジメチル-c-プロポキシ、2,3-ジメチル-c-プロポキシ、1-エチル-c-プロポキシ、2-エチル-c-プロポキシ、n-ヘキシル オキシ、1-メチル-n-ペンチルオキシ、2-メチル-n-ペンチルオキシ、3-メチル-n-ペンチ ルオキシ、4-メチル-n-ペンチルオキシ、1,1-ジメチル-n-ブトキシ、1,2-ジメチル-n-ブ トキシ、1,3-ジメチル-n-プトキシ、2,2-ジメチル-n-ブトキシ、2,3-ジメチル-n-プトキ シ、3,3-ジメチル-n-ブトキシ、1-エチル-n-ブトキシ、2-エチル-n-ブトキシ、1,1,2-ト リメチル-n-プロポキシ、1,2,2-トリメチル-n-プロポキシ、1-エチル-1-メチル-n-プロポ キシ、1-エチル-2-メチル-n-プロポキシ、c-ヘキシルオキシ、1-メチル-c-ペンチルオキ シ、2-メチル-c-ペンチルオキシ、3-メチル-c-ペンチルオキシ、1-エチル-c-プトキシ、2 -エチル-c-ブトキシ、3-エチル-c-ブトキシ、1,2-ジメチル-c-ブトキシ、1,3-ジメチル-c-ブトキシ、2,2-ジメチル-c-ブトキシ、2,3-ジメチル-c-ブトキシ、2,4-ジメチル-c-ブト キシ、3,3-ジメチル-c-ブトキシ、1-n-プロピル-c-プロポキシ、2-n-プロピル-c-プロポ キシ、1-i-プロピル-c-プロポキシ、2-i-プロピル-c-プロポキシ、1,2,2-トリメチル-c-プロポキシ、1,2,3-トリメチル-c-プロポキシ、2,2,3-トリメチル-c-プロポキシ、1-エチ ル-2-メチル-c-プロポキシ、2-エチル-1-メチル-c-プロポキシ、2-エチル-2-メチル-c-プ ロポキシ及び2-エチル-3-メチル-c-プロポキシ等が挙げられる。

[0037]

С1-6 アルコキシカルボニル基としては、直鎖、分枝及びС3-6 シクロアルコキシ カルボニル基を含んでいてもよく、メトキシカルボニル、エトキシカルボニル、n-プロポ キシカルボニル、i-プロポキシカルボニル、c-プロポキシカルボニル、n-ブトキシカルボ ニル、i-ブトキシカルボニル、s-ブトキシカルボニル、t-ブトキシカルボニル、c-プトキ シカルボニル、1-メチル-c-プロポキシカルボニル、2-メチル-c-プロポキシカルボニル、 n-ペンチルオキシカルボニル、1-メチル-n-ブトキシカルボニル、2-メチル-n-ブトキシカ ルボニル、3-メチル-n-ブトキシカルボニル、1,1-ジメチル-n-プロポキシカルボニル、1, 2-ジメチル-n-プロポキシカルボニル、2,2-ジメチル-n-プロポキシカルボニル、1-エチル -n-プロポキシカルボニル、c-ペンチルオキシカルボニル、1-メチル-c-ブトキシカルボニ ル、2-メチル-c-ブトキシカルボニル、3-メチル-c-ブトキシカルボニル、1,2-ジメチル-c -プロポキシカルボニル、2,3-ジメチル-c-プロポキシカルボニル、1-エチル-c-プロポキ シカルボニル、2-エチル-c-プロポキシカルボニル、n-ヘキシルオキシカルボニル、1-メ チル-n-ペンチルオキシカルボニル、2-メチル-n-ペンチルオキシカルボニル、3-メチル-n -ペンチルオキシカルボニル、4-メチル-n-ペンチルオキシカルボニル、1,1-ジメチル-n-ブトキシカルボニル、1,2-ジメチル-n-ブトキシカルボニル、1,3-ジメチル-n-プトキシカ ルボニル、2,2-ジメチル-n-ブトキシカルボニル、2,3-ジメチル-n-ブトキシカルボニル、 3.3-ジメチル-n-ブトキシカルボニル、1-エチル-n-ブトキシカルボニル、2-エチル-n-プ トキシカルボニル、1,1,2-トリメチル-n-プロポキシカルボニル、1,2,2-トリメチル-n-プ ロポキシカルボニル、1-エチル-1-メチル-n-プロポキシカルボニル、1-エチル-2-メチルn-プロポキシカルボニル、c-ヘキシルオキシカルボニル、1-メチル-c-ペンチルオキシカ ルボニル、2-メチル-c-ペンチルオキシカルボニル、3-メチル-c-ペンチルオキシカルボニ ル、1-エチル-c-ブトキシカルボニル、2-エチル-c-ブトキシカルボニル、3-エチル-c-ブ



トキシカルボニル、1,2-ジメチル-c-ブトキシカルボニル、1,3-ジメチル-c-ブトキシカルボニル、2,3-ジメチル-c-ブトキシカルボニル、2,4-ジメチル-c-ブトキシカルボニル、3,3-ジメチル-c-ブトキシカルボニル、1-n-プロピル-n-プロピル-n-プロピル-n-プロピル-n-プロピル-n-プロピル-n-プロピル-n-プロピル-n-プロピル-n-プロピル-n-プロピル-n-プロピル-n-プロピル-n-プロピル-n-プロピル-n-プロピル-n-プロピル-n-プロポキシカルボニル、n-n-プロピル-n-プロポキシカルボニル、n-n-プロピル-n-プロポキシカルボニル、n-n-プロポキシカルボニル、n-n-プロポキシカルボニル、n-n-プロポキシカルボニル、n-n-プロポキシカルボニル、n-n-プロポキシカルボニル、n-n-プロポキシカルボニル、n-n-プロポキシカルボニル、n-n-プロポキシカルボニル及びn-n-プロポキシカルボニル及びn-n-プロポキシカルボニルをが挙げられる。

[0038]

С1-6 アルキルカルボニルオキシ基としては、直鎖、分枝及びС3-6 シクロアルキ ルカルボニルオキシ基を含んでいてもよく、メチルカルボニルオキシ、エチルカルボニル オキシ、n-プロピルカルボニルオキシ、i-プロピルカルボニルオキシ、c-プロピルカルボ ニルオキシ、n-ブチルカルボニルオキシ、i-ブチルカルボニルオキシ、s-ブチルカルボニ ルオキシ、t-ブチルカルボニルオキシ、c-ブチルカルボニルオキシ、1-メチル-c-プロピ ルカルボニルオキシ、2-メチル-c-プロピルカルボニルオキシ、n-ペンチルカルボニルオ キシ、1-メチル-n-ブチルカルボニルオキシ、2-メチル-n-ブチルカルボニルオキシ、3-メ チル-n-ブチルカルボニルオキシ、1,1-ジメチル-n-プロピルカルボニルオキシ、1,2-ジメ チル-n-プロピルカルボニルオキシ、2,2-ジメチル-n-プロピルカルボニルオキシ、1-エチ ル-n-プロピルカルボニルオキシ、c-ペンチルカルボニルオキシ、1-メチル-c-ブチルカル ボニルオキシ、2-メチル-c-ブチルカルボニルオキシ、3-メチル-c-ブチルカルボニルオキ シ、1,2-ジメチル-c-プロピルカルボニルオキシ、2,3-ジメチル-c-プロピルカルボニルオ キシ、1-エチル-c-プロピルカルボニルオキシ、2-エチル-c-プロピルカルボニルオキシ、 n-ヘキシルカルボニルオキシ、1-メチル-n-ペンチルカルボニルオキシ、2-メチル-n-ペン チルカルボニルオキシ、3-メチル-n-ペンチルカルボニルオキシ、4-メチル-n-ペンチルカ ルボニルオキシ、1,1-ジメチル-n-ブチルカルボニルオキシ、1,2-ジメチル-n-ブチルカル ボニルオキシ、1.3-ジメチル-n-ブチルカルボニルオキシ、2,2-ジメチル-n-ブチルカルボ ニルオキシ、2,3-ジメチル-n-ブチルカルボニルオキシ、3,3-ジメチル-n-ブチルカルボニ ルオキシ、1-エチル-n-ブチルカルボニルオキシ、2-エチル-n-ブチルカルボニルオキシ、 1.1.2-トリメチル-n-プロピルカルボニルオキシ、1.2.2-トリメチル-n-プロピルカルボニ ルオキシ、1-エチル-1-メチル-n-プロピルカルボニルオキシ、1-エチル-2-メチル-n-プロ ピルカルボニルオキシ、c-ヘキシルカルボニルオキシ、1-メチル-c-ペンチルカルボニル オキシ、2-メチル-c-ペンチルカルボニルオキシ、3-メチル-c-ペンチルカルボニルオキシ 、1-エチル-c-ブチルカルボニルオキシ、2-エチル-c-ブチルカルボニルオキシ、3-エチル -c-ブチルカルボニルオキシ、1,2-ジメチル-c-ブチルカルボニルオキシ、1,3-ジメチル-c -ブチルカルボニルオキシ、2,2-ジメチル-c-ブチルカルボニルオキシ、2,3-ジメチル-c-ブチルカルボニルオキシ、2,4-ジメチル-c-ブチルカルボニルオキシ、3,3-ジメチル-c-ブ チルカルボニルオキシ、1-n-プロピル-c-プロピルカルボニルオキシ、2-n-プロピル-c-プ ロピルカルボニルオキシ、1-i-プロピル-c-プロピルカルボニルオキシ、2-i-プロピル-c-プロピルカルボニルオキシ、1,2,2-トリメチル-c-プロピルカルボニルオキシ、1,2,3-ト リメチル-c-プロピルカルボニルオキシ、2,2,3-トリメチル-c-プロピルカルボニルオキシ 、1-エチル-2-メチル-c-プロピルカルボニルオキシ、2-エチル-1-メチル-c-プロピルカル ボニルオキシ、2-エチル-2-メチル-c-プロピルカルボニルオキシ及び2-エチル-3-メチルc-プロピルカルボニルオキシ等が挙げられる。

[0039]

 C_{4-12} 芳香族基としては、2-フリル、3-フリル、2-チエニル、3-チエニル、フェニル、 α ーナフチル、 β ーナフチル、0ービフェニリル、mービフェニリル及びpービフェニリル等が挙げられる。

[0040]

次に、 R^1 及び R^2 の各置換基における具体例について説明する。



[0041]

R¹の具体例としては、メチル、エチル、n-プロピル、i-プロピル、c-プロピル、n-プチ ル、i-ブチル、s-ブチル、t-ブチル、c-ブチル、1-メチル-c-プロピル、2-メチル-c-プロ ピル、n-ペンチル、1-メチル-n-ブチル、2-メチル-n-ブチル、3-メチル-n-ブチル、1,1-ジメチル-n-プロピル、1,2-ジメチル-n-プロピル、2,2-ジメチル-n-プロピル、1-エチルn-プロピル、c-ペンチル、1-メチル-c-ブチル、2-メチル-c-ブチル、3-メチル-c-ブチル 、1,2-ジメチル-c-プロピル、2,3-ジメチル-c-プロピル、1-エチル-c-プロピル、2-エチ ν_{-c} -プロピル、n-ヘキシル、1-メチル-n-ペンチル、2-メチル-n-ペンチル、3-メチル-n-ペンチル、4-メチル-n-ペンチル、1,1-ジメチル-n-プチル、1,2-ジメチル-n-プチル、1,3-ジメチル-n-ブチル、2,2-ジメチル-n-ブチル、2,3-ジメチル-n-ブチル、3,3-ジメチル-n _ブチル、1-エチル-n-ブチル、2-エチル-n-ブチル、1.1,2-トリメチル-n-プロピル、1,2, 2-トリメチル-n-プロピル、1-エチル-1-メチル-n-プロピル、1-エチル-2-メチル-n-プロ ピル、c-ヘキシル、1-メチル-c-ペンチル、2-メチル-c-ペンチル、3-メチル-c-ペンチル 、1-エチル-c-ブチル、2-エチル-c-ブチル、3-エチル-c-ブチル、1,2-ジメチル-c-ブチル 、1.3-ジメチル-c-ブチル、2.2-ジメチル-c-ブチル、2.3-ジメチル-c-ブチル、2,4-ジメ チル-c-ブチル、3,3-ジメチル-c-ブチル、1-n-プロピル-c-プロピル、2-n-プロピル-c-プ ロピル、1-i-プロピル-c-プロピル、2-i-プロピル-c-プロピル、1,2,2-トリメチル-c-プ ロピル、1.2.3-トリメチル-c-プロピル、2.2.3-トリメチル-c-プロピル、1-エチル-2-メ チル-c-プロピル、2-エチル-1-メチル-c-プロピル、2-エチル-2-メチル-c-プロピル、2-エチル-3-メチル-c-プロピル、c-ヘプチル、c-オクチル、2-フリル、3-フリル、2-チ エニル、3-チエニル、フェニル、o-メチルフェニル、m-メチルフェニル、p-メチルフェニ ル、o-メトキシフェニル、m-メトキシフェニル、p-メトキシフェニル、o-ベンジルオキシ フェニル、m-ベンジルオキシフェニル、p-ベンジルオキシフェニル、o-クロロフェニル、 m-クロロフェニル、p-クロロフェニル、o-ブロモフェニル、m-ブロモフェニル、p-ブロモ フェニル、 α ーナフチル、 β ーナフチル及びベンジル等が挙げられ、又、nープロピル、 i-プロピル、t-ブチル、cーペンチル、cーヘキシル、cーヘプチル、フェニル、p-ベン ジルオキシフェニル、m-メチルフェニル、p-メチルフェニル、βーナフチル、p-プロモフ ェニル及び2-フリルが挙げられる。

[0042]

 R^2 の具体例としては、メチル、エチル、n-プロピル、i-プロピル、c-プロピル、n-ブチ ル、i-ブチル、s-ブチル、t-ブチル、c-ブチル、1-メチル-c-プロピル、2-メチル-c-プロ ピル、n-ペンチル、1-メチル-n-ブチル、2-メチル-n-ブチル、3-メチル-n-ブチル、1,1-ジメチル-n-プロピル、1,2-ジメチル-n-プロピル、2,2-ジメチル-n-プロピル、1-エチルn-プロピル、c-ペンチル、1-メチル-c-ブチル、2-メチル-c-ブチル、3-メチル-c-ブチル 、1,2-ジメチル-c-プロピル、2,3-ジメチル-c-プロピル、1-エチル-c-プロピル、2-エチ ν_{-c} -プロピル、n-ヘキシル、1-メチル-n-ペンチル、2-メチル-n-ペンチル、3-メチル-n-ペンチル、4-メチル-n-ペンチル、1.1-ジメチル-n-プチル、1.2-ジメチル-n-ブチル、1.3-ジメチル-n-ブチル、2,2-ジメチル-n-ブチル、2,3-ジメチル-n-ブチル、3,3-ジメチル-n-ブチル、1-エチル-n-ブチル、2-エチル-n-ブチル、1,1,2-トリメチル-n-プロピル、1,2, 2-トリメチル-n-プロピル、1-エチル-1-メチル-n-プロピル、1-エチル-2-メチル-n-プロ ピル、c-ヘキシル、1-メチル-c-ペンチル、2-メチル-c-ペンチル、3-メチル-c-ペンチル 、1-エチル-c-ブチル、2-エチル-c-ブチル、3-エチル-c-ブチル、1,2-ジメチル-c-ブチル 、1,3-ジメチル-c-プチル、2,2-ジメチル-c-プチル、2,3-ジメチル-c-プチル、2,4-ジメ チル-c-ブチル、3,3-ジメチル-c-ブチル、1-n-プロピル-c-プロピル、2-n-プロピル-c-プ ロピル、1-i-プロピル-c-プロピル、2-i-プロピル-c-プロピル、1,2,2-トリメチル-c-プ ロピル、1,2,3-トリメチル-c-プロピル、2,2,3-トリメチル-c-プロピル、1-エチル-2-メ チル-c-プロピル、2-エチル-1-メチル-c-プロピル、2-エチル-2-メチル-c-プロピル、2-エチル-3-メチル-c-プロピル、c-ヘプチル、c-オクチル、フェニル及びベンジル等が 挙げられ、又、メチル及びベンジルが挙げられる。

[0043]



好ましい式(1)で表される α -アミノアシル酢酸エステル化合物としては、以下のものが挙げられる。

[0044]

1) R^1 が C_{1-20} アルキル基又は C_{4-12} 芳香族基(該芳香族基は、ハロゲン原子、 C_{1-6} アルキル基、 C_{1-6} アルコキシ基又はベンジルオキシ基で任意に置換されていてもよい。)である式(1)で表される α - アミノアシル酢酸エステル化合物。

[0045]

2) R^2 が C_{1-6} アルキル基又は C_{4-12} 芳香族基で置換された C_{1-6} アルキル基である式(1)で表される α - アミノアシル酢酸エステル化合物。

[0046]

3) R^1 が C_{1-20} アルキル基又は C_{4-12} 芳香族基(該芳香族基は、ハロゲン原子、 C_{1-6} アルキル基、 C_{1-6} アルコキシ基又はベンジルオキシ基で任意に置換されていてもよい。)であり、 R^2 が C_{1-6} アルキル基又は C_{4-12} 芳香族基で置換された C_{1-6} アルキル基である式(1)で表される α - アミノアシル酢酸エステル化合物。

[0047]

4) R^1 がn -プロピル、i-プロピル、t-ブチル、c -ペンチル、c -ヘキシル、c -ヘプチル、p-ベンジルオキシフェニル、m-メチルフェニル、p-メチルフェニル、 β -ナフチル、p-ブロモフェニル又は2-フリルである式(1)で表される α -アミノアシル酢酸エステル化合物。

[0048]

5) R^2 がメチル又はベンジルである式(1) で表される α – アミノアシル酢酸エステル化合物。

[0049]

6) R^1 がn-プロピル、i-プロピル、t-プチル、c-ペンチル、c-ヘキシル、c-ヘプチル、フェニル、p-ベンジルオキシフェニル、m-メチルフェニル、p-メチルフェニル、 β -ナフチル、p-ブロモフェニル又は2-フリルであり、 R^2 がメチル又はベンジルである式(1) で表される α -アミノアシル酢酸エステル化合物。

[0050]

本発明の触媒的不斉水素化反応に用いられる触媒としては、通常の触媒的不斉水素化反応に用いられる触媒を使用することができる。(R. Noyori ed. Asymmetric Catalysis i nOrganic Synthesis, (1994) Jhon Wiley &; Sons, Inc, New York参照。)

好ましい触媒としては、光学活性ホスフィン配位子を有する、周期表第VIII族の遷移金 属錯体が挙げられる。

[0051]

周期表第VIII族の遷移金属としては、鉄、コバルト、ニッケル、ルテニウム、ロジウム、パラジウム、オスミウム、イリジウム及び白金が挙げられるが、ルテニウム、ロジウム及びイリジウムが好ましい。

[0052]

本発明に使用する光学活性ホスフィン配位子は全て光学活性体となる。

[0053]

光学活性ホスフィン配位子としては、光学活性2座ホスフィン配位子が好ましい。

[0054]

光学活性2座ホスフィン配位子としては、BINAP、BIPHEMP、RROPHOS、DEGUPHOS、DIOP、DIPAMP、DuPHOS、NORPHOS、PNNP、SKEWPHOS、BPPFA、SEGPHOS、CHIRAPHOS及びH₈-BINAP等が挙げられる。

[0055]

BINAPとしては、BINAPの誘導体も含まれ、具体例としては、2,2'-ビス(ジフェニルホスフィノ)-1,1'-ビナフチル、2,2'-ビス(ジ-p-トリルホスフィノ)-1,1'-ビナフチル、2,2'-ビス(ジ-p-第 3 級プチルフェニルホスフィノ)-1,1'-ビナフチル、2,2'-ビス(ジ-m-トリルホスフィノ)-1,1'-ビナフチル、2,2'-ビス(ジ-3,5-ジメチルフェニ



ルホスフィノ)-1,1' -ビナフチル、2,2' -ビス(ジ-p-メトキシフェニルホスフィノ)-1,1' -ビナフチル、2,2' -ビス(ジシクロペンチルホスフィノ)-1,1' -ビナフチル、2,2' -ビス(ジシクロヘキシルホスフィノ)-1,1' -ビナフチル、2-ジ(β -ナフチル)ホスフィノ-2' -ジフェニルホスフィノ-1,1' -ビナフチル及び2-ジフェニルホスフィノ-2' -ジ(β -ナフチルフェニル)ホスフィノ-1,1' -ビナフチル等が挙げられ、好ましくは、 α , α -ビス(ジフェニルホスフィノ) α , α -ビナフチル、 α , α -ビス(ジーp-トリルホスフィノ) α , α -ビナフチル及び α , α -ビオフチルが挙げられる。

[0056]

BIPHEMPとしては、BIPHEMPの誘導体も含まれ、具体例としては、2,2' -ジメチル-6,6' -ビス(ジフェニルホスフィノ)-1,1' -ビフェニル、2,2' -ジメチル-6,6' -ビス(ジシクロヘキシルホスフィノ)-1,1' -ビフェニル、2,2' -ジメチル-4,4' -ビス(ジメチルアミノ)-6,6' -ビス(ジフェニルホスフィノ)-1,1' -ビフェニル、2,2' ,4,4' -テトラメチル-6,6' -ビス(ジフェニルホスフィノ)-1,1' -ビフェニル、2,2' ,3,3' -テトラメトキシ-6,6' -ビス(ジフェニルホスフィノ)-1,1' -ビフェニル、2,2' ,3,3' -テトラメトキシ-6,6' -ビス(ジフェニルホスフィノ)-1,1' -ビフェニル、2,2' ,4,4' -テトラメチル-3,3' -ジメトキシ-3,0' -ビス(ジフェニルホスフィノ)-1,1' -ビフェニル、1,0' -ビフェニル、1,0' -ビス(ジーP-トリルホスフィノ)-1,0' -ビフェニル及び1,0' -ビス(ジーP-メトキシフェニルホスフィノ)-1,0' -ビフェニルが挙げられ、好ましくは1,0' -ビス(ジフェニルホスフィノ)-1,0' -ビフェニルが挙げられる。

[0057]

その他の光学活性2座ホスフィン配位子及びその誘導体の例を以下に図示するが、これらに限定されるものではない。

[0058]

【化5】

PROPHOS =
$$R^b = P(C_0H_0)_2$$
 PROPHOS : $R^b = CH_3$ BENZPHOS : $R^b = C_0H_0CH_2$ CyCPHOS : $R^b = c_0C_0H_{11}$

DIOP =
$$PR^{3}_{2}$$
 DIOP : $R^{3} = C_{6}H_{5}$
 PR^{3}_{2} CyDIOP : $R^{3} = C_{-}C_{6}H_{11}$

DuPHOS =
$$R^b = C_2H_5$$

 $R^b = C_2H_5$
 $R^b = C_2H_5$
 $R^b = C_2H_5$
 $R^b = C_2H_5$

[0059]



【化6】

NORPHOS =
$$P(C_6H_5)_2$$
 PNNP = $P(C_6H_5)_2$ PPFA = $P(C_6H_5)_2$ PPFA = $P(C_6H_5)_2$ PPFA = $P(C_6H_5)_2$ PPFOH : X = OH

SEGPHOS = $P(C_6H_5)_2$ PPC $F(C_6H_5)_2$ PPC $F(C_6H_$

[0060]

本発明の触媒的不斉水素化反応に用いられる触媒は、遷移金属化合物及び光学活性ホスフィン配位子より調製することができるが、必要に応じて配位可能な添加物を加えることもできる。

[0061]

遷移金属化合物としては、ジー μ -クロロテトラキス(シクロオクテン)2ロジウム、ジー μ -クロロビス(1,5-シクロオクタジエン)2ロジウム及び1,5-シクロオクタジエンビス(アセトニトリル)ロジウムテトラフルオロホウ酸塩等のロジウム化合物、ジー μ -クロロテトラキス(シクロオクテン)2イリジウム、ジー μ -クロロビス(1,5-シクロオクタジエン)2イリジウム、ジー μ -クロロテトラキス(エチレン)2イリジウム及び1,5-シクロオクタジエンビス(アセトニトリル)イリジウムテトラフルオロホウ酸塩等のイリジウム化合物、テトラクロロ(η -ベンゼン)2ルテニウム及びテトラクロロ(η -(p-シメン))2ルテニウム等のルテニウム化合物等が挙げられる。

[0062]

添加物としては、配位可能な化合物で有れば特に限定はしないが、例えば、ルテニウム化合物を使用する場合は、N,N-ジメチルホルムアミド等が好ましく、イリジウム化合物を使用する場合には、ヨウ素化合物が好ましい。

[0063]

ヨウ素化合物の具体例としては、ヨウ化テトラメチルアンモニウム、ヨウ化テトラn-ブチルアンモニウム、ヨウ化ナトリウム及びヨウ化カリウム等が挙げられ、好ましくはヨウ化ナトリウムが挙げられる。

[0064]

光学活性ホスフィン配位子の使用量は、光学活性 2 座ホスフィン配位子として、遷移金属化合物に対して 1 等量以上、好ましくは $1\sim 2$ 等量加えられ、より好ましくは、1.1 ~ 1.5 等量加えられる。

[0065]

但し、遷移金属化合物と光学活性2座ホスフィン配位子が1:2の組成となる触媒的不 斉水素化反応に用いられる触媒においては、上述の2倍の使用量となる。

[0.066]

又、光学活性単座ホスフィン配位子を使用する場合は、価数の関係上、上述の 2 倍の使 用量となる。

[0067]

添加物を加える際の使用量としては、触媒の組成比により一概には決定できないが、通常遷移金属化合物の使用量に対して1~100等量の範囲、好ましくは、1~10等量の範囲である。

[0068]



触媒的不斉水素化反応に用いられる触媒を調製する際は、通常、アルゴン等の不活性ガスの存在下で行うことが好ましい。

[0069]

触媒的不斉水素化反応に用いられる触媒のうち、ルテニウム触媒に付き更に詳細に説明 する。

[0070]

ルテニウムー光学活性ホスフィン錯体としては、ルテニウムーBINAP錯体、ルテニウムーBIPHEMP錯体、ルテニウムーRROPHOS錯体、ルテニウムーDEGUPHOS錯体、ルテニウムーDI OP錯体、ルテニウムーDIPAMP錯体、ルテニウムーDuPHOS錯体、ルテニウムーNORPHOS錯体、ルテニウムーPNNP錯体、ルテニウムーSKEWPHOS錯体、ルテニウムーBPPFA錯体、ルテニウムーSEGPHOS錯体、ルテニウムーCHIRAPHOS錯体及びルテニウムーH₈-BINAP錯体等が挙げられる。

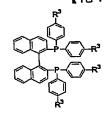
[0071]

以下、ルテニウムーBINAP錯体について詳細を記載するが、同様に他の光学活性ホスフィン配位子を用いてもよい。

[0072]

ルテニウム - BINAP錯体としては、RuHX 1 (R 3 - BINAP) $_2$ 、RuX 2 (R 3 - BINAP) $_2$ (Et₃ N) (式中、X 1 及びX 2 は、それぞれC1、C1O₄、BF₄、PF₆、OCOCH₃、OCOCF₃、OCO - t- Bu又はOSO₂ CF₃ を意味し、R 3 - BINAPは、

【0073】 【化7】



[0074]

(式中、R³は、水素原子、メチル基又は三級ブチル基を意味し、絶対配置はS又はRのど ちらかを意味する。)を意味するが、該錯体は、N,N-ジメチルホルムアミド、ベンゼン、 AlCl₃、SnCl₄、TiCl₄又はZnCl₂で更に配位されていてもよい。)が挙げられ、具体的には 、RuHC1(BINAP)₂、RuHC1(T-BINAP)₂、RuHC1(t-Bu-BINAP)₂、RuH(C1O₄)(BINAP)₂、RuH(C1O 4) $(T-BINAP)_2$, $RuH(BF_4)$ $(BINAP)_2$, $RuH(BF_4)$ $(T-BINAP)_2$, $RuH(PF_6)$ $(BINAP)_2$, $RuH(PF_6)$ $(T-BINAP)_2$ -BINAP)₂, RuCl₂ (BINAP), RuCl₂ (T-BINAP), RuCl₂ (t-Bu-BINAP), RuCl₂ (BINAP) (dmf)_n, R $\label{eq:ucl2} uCl_2\,(T-BINAP)\,(dmf)_n\,,\;RuCl_2\,(t-Bu-BINAP)\,(dmf)_n\,,\;RuCl_2\,(BINAP)\,(C_6\,H_6\,)_n\,,\;RuCl_2\,(T-BINAP)\,(dmf)_n\,,\;RuCl_2\,(T-BINAP)\,(dmf)_n\,,\;RuCl_2\,(T-BINAP)\,(dmf)_n\,,\;RuCl_2\,(T-BINAP)\,(dmf)_n\,,\;RuCl_2\,(T-BINAP)\,(dmf)_n\,,\;RuCl_2\,(T-BINAP)\,(dmf)_n\,,\;RuCl_2\,(T-BINAP)\,(dmf)_n\,,\;RuCl_2\,(T-BINAP)\,(dmf)_n\,,\;RuCl_2\,(T-BINAP)\,(dmf)_n\,,\;RuCl_2\,(T-BINAP)\,(dmf)_n\,,\;RuCl_2$) $(C_6H_6)_n$, $RuCl_2(t-Bu-BINAP)(C_6H_6)_n$, $Ru(ClO_4)_2(BINAP)$, $Ru(ClO_4)_2(T-BINAP)$, $Ru(ClO_4)_2(T-BINAP)$ $_4$) $_2$ (t-Bu-BINAP), Ru(BF4) $_2$ (BINAP), Ru(BF4) $_2$ (T-BINAP), Ru(BF4) $_2$ (t-Bu-BINAP), Ru(PF 6)2 (BINAP), Ru(PF6)2 (T-BINAP), Ru(OCOCH3)2 (BINAP), Ru(OCOCF3)2 (BINAP), Ru(OCO-t- $Bu)_2$ (BINAP), $Ru(OCOCH_3)_2$ (T-BINAP), $Ru(OCOCF_3)_2$ (T-BINAP), $Ru(OCOCH_3)_2$ (t-Bu-BINAP) $Ru(OCOCH_3)_2$ (BINAP) (ZnCl₂), $Ru(OCOCH_3)_2$ (BINAP) (AlCl₃), $Ru(OCOCH_3)_2$ (BINAP) (SnCl₄)), Ru(OCOCH₃)₂ (BINAP) (TiCl₄), Ru(OCOCH₃)₂ (T-BINAP) (ZnCl₂), Ru(OCOCH₃)₂ (T-BINAP) (A1Cl₃), Ru(OCOCH₃)₂ (T-BINAP) (SnCl₄), Ru(OCOCH₃)₂ (T-BINAP) (TiCl₄), Ru₂Cl₄ (BINAP)₂ (Et₃N), Ru₂Cl₄ (T-BINAP)₂ (Et₃N), Ru₂Cl₄ (t-Bu-BINAP)₂ (Et₃N), Ru₂Cl₄ (BINAP)₂ (ZnCl₂) 2 (Et₃N), Ru₂Cl₄ (BINAP)₂ (AlCl₃)₂ (Et₃N), Ru₂Cl₄ (BINAP)₂ (SnCl₄)₂ (Et₃N), Ru₂Cl₄ (BINA P) 2 (TiCl₄) 2 (Et₃N), Ru₂Cl₄ (T-BINAP) 2 (ZnCl₂) 2 (Et₃N), Ru₂Cl₄ (T-BINAP) 2 (AlCl₃) 2 (Et₃N)、Ru₂Cl₄ (T-BINAP)₂ (SnCl₄)₂ (Et₃N)及びRu₂Cl₄ (T-BINAP)₂ (TiCl₄)₂ (Et₃N)等が挙げられ る。(式中、BINAPは、絶対配置がS又はRの、2,2'-ビス(ジフェニルホスフィノ)-1, 1'-ビナフチルを意味し、T-BINAPは、絶対配置がS又はRの、2,2'-ビス(ジ-p-トリル ホスフィノ) -1,1'-ビナフチルを意味し、t-Bu-BINAPは、絶対配置がS又はRの、2,2' -ビス (ジ-p-t-プチルフェニルホスフィノ) -1,1'-ビナフチルを意味し、Etはエチル



基を意味し、t-Buは、t-プチル基を意味し、dmfは、N,N-ジメチルホルムアミドを意味し、nは1又は2を意味する。)

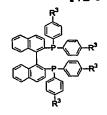
[0075]

好ましい、ルテニウムー光学活性ホスフィン錯体としては、以下のものが挙げられる。 【0076】

1) RuHX¹(R³-BINAP)2、RuX²2(R³-BINAP)又はRu2Cl4(R³-BINAP)2(Et3N)(式中、X¹及びX²は、それぞれCl、Cl04、BF4、PF6、OCOCH3、OCOCF3、OCO-t-Bu又はOSO2CF3を意味し、R³-BINAPは、

[0077]

【化8】



[0078]

(式中、 R^3 は、水素原子、メチル基又は三級ブチル基を意味し、絶対配置はS又はRのどちらかを意味する。)を意味するが、該錯体は、N,N-ジメチルホルムアミド、ベンゼン、 $A1C1_3$ 、 $SnC1_4$ 、 $TiC1_4$ 又は $ZnC1_2$ で更に配位されていてもよい。)であるルテニウムー光学活性ホスフィン錯体。

[0079]

2) RuX²₂ (R³-BINAP)である 1) 記載のルテニウムー光学活性ホスフィン錯体。

[0080]

3) X^2 がClであり、N, N-ジメチルホルムアミド又はベンゼンで更に配位された RuX^2 ₂ (R^3 -B INAP)である 2) に記載のルテニウムー光学活性ホスフィン錯体。

[0081]

4) RuCl₂ (BINAP)、RuCl₂ (T-BINAP)、RuCl₂ (t-Bu-BINAP)、RuCl₂ (BINAP) (dmf)_n、RuCl₂ (T-BINAP) (dmf)_n、RuCl₂ (T-BINAP) (dmf)_n、RuCl₂ (T-BINAP) (C₆H₆)_n、RuCl₂ (T-BINAP) (C₆H₆)_n 、RuCl₂ (T-BINAP) (T-BINAP) (T-BINAP) (T-BINAP) (T-BINAP) (T-BINAP) (T-BINAP) (T-BINAP) (T-BINAP)

[0082]

5) RuCl₂ (BINAP) (dmf)_n、RuCl₂ (T-BINAP) (dmf)_n又はRuCl₂ (t-Bu-BINAP) (dmf)_n(式中、BINAPは、絶対配置がS又はRの、2,2'-ビス(ジフェニルホスフィノ)-1,1'-ビナフチルを意味し、T-BINAPは、絶対配置がS又はRの、2,2'-ビス(ジ-p-トリルホスフィノ)-1,1'-ビナフチルを意味し、t-Bu-BINAPは、絶対配置がS又はRの、2,2'-ビス(ジ-p-tープチルフェニルホスフィノ)-1,1'-ビナフチルを意味し、dmfは、N,N-ジメチルホルムアミドを意味し、nは1又は2を意味する。)であるルテニウムー光学活性ホスフィン錯体。

[0083]

6) $RuCl_2$ (BINAP) $(dmf)_n$ (式中、BINAPは、絶対配置がS又はRの、2,2'-ビス(ジフェニルホスフィノ)-1,1'-ビナフチルを意味し、dmfは、N,N-ジメチルホルムアミドを意味し、nは1又は2を意味する。)であるルテニウムー光学活性ホスフィン錯体。

[0084]

触媒的不斉水素化反応に用いられる触媒のうち、イリジウム触媒に付き更に詳細に説明する。



[0085]

イリジウムー光学活性ホスフィン錯体としては、イリジウムーBINAP錯体、イリジウムーBIPHEMP錯体、イリジウムーRROPHOS錯体、イリジウムーDEGUPHOS錯体、イリジウムーDI OP錯体、イリジウムーDIPAMP錯体、イリジウムーDuPHOS錯体、イリジウムーNORPHOS錯体、イリジウムーPNNP錯体、イリジウムーSKEWPHOS錯体、イリジウムーBPPFA錯体、イリジウムーSEGPHOS錯体、イリジウムーCHIRAPHOS錯体及びイリジウムーH₈-BINAP錯体等が挙げられる。

[0086]

好ましいイリジウムー光学活性ホスフィン錯体としては、以下のものが挙げられる。

[0087]

1) イリジウムーBINAP錯体又はイリジウムーBIPHEMP錯体であるイリジウムー光学活性ホスフィン錯体。

[0088]

2) イリジウムーBINAP錯体であり、BINAPが、BINAP、T-BINAP又はt-Bu-BINAPである 1) 記載のイリジウムー光学活性ホスフィン錯体。

[0089]

3) イリジウムーBIPHEMP錯体であり、BIPHEMPが2,2'-ジメトキシ-6,6'-ビス(ジフェニルホスフィノ)-1,1'-ビフェニル(MeO-Biphep)である1)記載のイリジウムー光学活性ホスフィン錯体。

[0090]

4) 添加物としてヨウ素化合物を加える2) に記載のイリジウムー光学活性ホスフィン錯体。

[0091]

5) 添加物としてヨウ素化合物を加える3) に記載のイリジウムー光学活性ホスフィン錯体。

[0092]

6) ヨウ素化合物が、ヨウ素化ナトリウム又はヨウ素化テトラn-ブチルアンモニウムである5) 記載のイリジウムー光学活性ホスフィン錯体。

[0093]

7) 遷移金属化合物として $[Ir(cod)C1]_2$ (式中、codは、1,5-シクロオクタジエンを意味する。)を使用する 1) \sim 5) の何れかに記載のイリジウムー光学活性ホスフィン錯体。

【0094】 8) イリジウムの使用量に対して、1~3等量のヨウ素化ナトリウムを添加物として使用する7) 記載のイリジウム-光学活性ホスフィン錯体。

[0095]

触媒的不斉水素化反応に用いられる触媒のうち、イリジウム触媒に付き更に詳細に説明 する。

[0096]

ロジウムー光学活性ホスフィン錯体としては、ロジウムーBINAP錯体、ロジウムーBIPHE MP錯体、ロジウムーRROPHOS錯体、ロジウムーDEGUPHOS錯体、ロジウムーDIOP錯体、ロジウムーDIPAMP錯体、ロジウムーDUPHOS錯体、ロジウムーNORPHOS錯体、ロジウムーPNNP錯体、ロジウムーSKEWPHOS錯体、ロジウムーBPPFA錯体、ロジウムーSEGPHOS錯体、ロジウムーCHIRAPHOS錯体及びロジウムーH8-BINAP錯体等が挙げられる。

【発明を実施するための最良の形態】

[0097]

本発明の光学活性 β - ヒドロキシー α - アミノカルボン酸誘導体の製造方法について説明する。

[0098]

式 (1) で表される α - アミノアシル酢酸エステル化合物を触媒的不斉水素化反応に用いられる触媒及び酸の存在下、水素で還元することにより、式 (2) 又は式 (3) で表さ

出証特2004-3075009



れる光学活性 β ーヒドロキシー α ーアミノカルボン酸誘導体を製造することができる。

[0099]

【化9】

[0100]

通常、本反応は溶媒中で行われる。

[0101]

溶媒の種類としては、反応に関与しない溶媒であれば特に限定はしないが、

例えば1, 1-ジクロロエタン、1, 2-ジクロロエタン、塩化メチレン、クロロホルム、クロロベンゼン及び1, <math>2-ジクロロベンゼン等のハロゲン系溶媒、ジエチルエーテル、ジイソプロピルエーテル、テトラヒドロフラン等のエーテル系溶媒、メタノール、エタノール、n-プロパノール、i-プロパノール、2-ブタノール及びエチレングリコール等のアルコール系溶媒、酢酸並びに上記の溶媒の任意の混合溶媒が挙げられる。

[0102]

好ましい溶媒としては、ハロゲン系溶媒、アルコール系溶媒、ハロゲン系溶媒とアルコール系溶媒の混合溶媒、ハロゲン系溶媒とエーテル系溶媒の混合溶媒、酢酸及び酢酸とアルコール系溶媒の混合溶媒が挙げられ、又、ハロゲン系溶媒、アルコール系溶媒、ハロゲン系溶媒とアルコール系溶媒の混合溶媒、酢酸、酢酸とアルコール系溶媒の混合溶媒及び酢酸とエーテル系溶媒の混合溶媒が挙げられ、又、メタノール、nープロパノール、iープロパノール、2ージクロロエチレングリコール、塩化メチレン、1,2ージクロロエタン、クロロベンゼン、メタノールー塩化メチレン、nープロパノールー塩化メチレン、iープロパノールー塩化メチレン、nープロパノールー塩化メチレン、nープロパノールのび酢酸ーテトラヒドロフランが挙げられ、又、塩化メチレン、nープロパノール、nープロパノールー塩化メチレン及び酢酸が挙げられる。

[0103]

又、ルテニウム触媒を用いる場合は、塩化メチレン、nープロパノール、nープロパノールー塩化メチレン等が好ましく、イリジウム触媒を用いる場合は、酢酸を用いるのが好ましい。

[0104]

触媒的不斉水素化反応に用いられる触媒の使用量は、式(1)で表される α ーアミノアシル酢酸エステル化合物の使用量に対して、0.01~100モル%の範囲であるが、反応効率及びコスト的な観点から好ましくは、0.01~20モル%の範囲、又、0.1~10モル%の範囲、又、0.3~5モル%の範囲が挙げられる。

[0105]

式(1)で表されるα-アミノアシル酢酸エステル化合物を酸の存在する溶液に加えてもよいが、あらかじめ、式(1)で表されるα-アミノアシル酢酸エステル化合物と酸よりなる塩を調製し、その塩を溶液に加えることもできる。

[0106]

 α -アミノアシル酢酸エステル化合物の安定性の観点からは、あらかじめ、式(1)で表される α -アミノアシル酢酸エステル化合物と酸よりなる塩を調製し、その塩を溶液に加える方が好ましい。

[0107]

使用する酸としては、好ましくは、強酸が挙げられる。

[0108]

強酸の具体例としては、HC1、HBr、H₂SO₄、HC1O₄、CH₃SO₃H、PhSO₃H、TsOH(Tsは、p-トルエンスルホニルを意味する。)、CF₃SO₃H及びCF₃CO₂H等が挙げられ、好ましくは、HC1及びTsOHが挙げられ、又、HC1が挙げられる。

[0109]



酸の使用量は、式(1)で表される α -アミノアシル酢酸エステル化合物の使用量に対して、 $0.8 \sim 3$ モル等量の範囲であり、好ましくは、 $0.9 \sim 2$ モル等量の範囲、又、 $0.9 \sim 1.5$ モル等量の範囲が挙げられる。

[0110]

尚、上記の酸の使用量は、あらかじめ、式 (1) で表される α - アミノアシル酢酸エステル化合物と酸よりなる塩を調製して加える場合は、その塩に含まれる酸の量を含んだ全量を意味する。

[0111]

又、反応系中に酢酸塩を添加することもできる。

[0112]

酢酸塩としては、酢酸リチウム、酢酸ナトリウム及び酢酸カリウム等の酢酸アルカリ金属及び酢酸アンモニウム等が挙げられ、好ましくは、酢酸アルカリ金属が挙げられ、又、酢酸ナトリウムが挙げられる。

[0113]

酢酸塩を添加する場合の使用量としては、式 (1) で表される α - アミノアシル酢酸エステル化合物の使用量に対して、0.8~5等量の範囲であり、好ましくは、0.8~2 等量の範囲である。

[0114]

特に、イリジウム触媒を用いる場合は酢酸塩を添加するのが好ましい。

[0115]

使用する水素は、通常水素ガスを使用する。

[0116]

使用する水素の圧力は、通常 $1\sim150$ 気圧の範囲であるが、好ましくは $10\sim150$ 気圧、又、好ましくは $30\sim100$ 気圧の範囲である。

[0117]

反応温度としては、0℃から溶媒の沸点までの範囲で反応を行うことができ、より好ましくは10~150℃の範囲であり、より好ましくは30~100℃の範囲である。

[0118]

反応時間は、反応温度により変化するため一概に決定できないが、例えば、反応温度が 50℃の場合、4時間以上、100℃の場合3時間以上行えば充分である。

[0119]

反応終了後は、溶媒を濃縮することにより、目的の光学活性 β ーヒドロキシー α ーアミノカルボン酸誘導体を塩として得ることができる。

[0120]

又、反応液を塩基性とし、適当な溶剤で抽出することにより目的の光学活性 β ーヒドロキシー α ーアミノカルボン酸誘導体を得ることができる。

[0121]

さらに、蒸留、再結晶及びシリカゲルカラムクロマトグラフィー等の常法による精製を行うことで、純度の高い純度の高い式(2)又は式(3)で表される光学活性 β ーヒドロキシー α ーアミノカルボン酸誘導体を単離することができる。

[0122]

本発明で得られる、式(2)又は式(3)で表される光学活性 β ーヒドロキシー α ーアミノカルボン酸誘導体のジアステレオ選択性(de:シン体とアンチ体の選択性)及びエナンチオ選択性(ee) は、得られた光学活性 β ーヒドロキシー α ーアミノカルボン酸誘導体をベンゾイル化した後、機器分析を行うことにより決定できる。

[0123]

ベンゾイル化の方法を以下に示す。

[0124]



【化10】

即ち、式 (2) 又は式 (3) で表される光学活性 β ーヒドロキシー α ーアミノカルボン酸誘導体又はその塩をテトラヒドロフラン中、トリエチルアミンの存在下、ベンゾイルクロリドと反応させることにより、式 (2) 又は式 (3) で表される光学活性 β ーヒドロキシー α ーアミノカルボン酸誘導体のベンゾイル化物を製造することができる。

[0126]

得られたベンゾイル化物は、シリカゲルカラムクロマトグラフィー等で精製した後、¹ H-NMR等により、ジアステレオ選択性(de:シン体とアンチ体の選択性)を、又、光学活性カラムを用いたHPLC分析等により、エナンチオ選択性(ee)を決定することができる。

[0127]

原料となる、式(1)で表される α -アミノアシル酢酸エステル化合物は、以下に示す方法により製造することができる。

[0128]

【化11】

[0129]

即ち、酸無水物又はアシルクロリドとイソニトリル酢酸エステルを塩基(塩基としては、トリエチルアミン、1, 8-ジアザビシクロ [5, 4, 0] ウンデカー7-エン等が挙げられる。)の存在下、縮合させて、オキサゾール化合物とした後、塩酸でオキサゾール環を開裂させることにより、式(1)で表される α -アミノアシル酢酸エステル化合物の塩酸塩を製造することができる。

[0130]

得られた塩酸塩をそのまま次の還元反応に使用することができる。

[0131]

得られた塩酸塩を塩基等で処理することにより、式(1)で表される α -アミノアシル酢酸エステル化合物とすることができる。

[0132]

又、他の酸の塩を得るには、オキサゾール化合物を他の酸で開裂させるか又は塩酸塩を 他の酸で塩交換することにより達成される。

[0133]

式 (1) で表される $\alpha-r$ ミノアシル酢酸エステル化合物の塩酸塩は、以下に示す方法でも同様に製造することができる。

[0134]

【化12】

ŅH₃*CI*



[0135]

即ち、グリシンをTsOH (pートルエンスルホン酸)の存在下、アルコールと脱水縮合させてエステルとした後、アミノ基をBoc化 (tープチルカルボニル化)する。

[0136]

KHMDS (カリウムヘキサメチルジシラジド) で処理した後、アシルクロリドを加えてアミド化した後、LHMDS (リチウムヘキサメチルジシラジド) 及びDMPU (1, 3 – ジメチルー3, 4, 5, 6 – パーハイドロピリミジンー 2 – オン) で処理することにより転位反応を行い α – アミノアシル酢酸エステル化合物のBoc体を得、塩酸でBocを脱離させることにより、式 (1) で表される α – アミノアシル酢酸エステル化合物の塩酸塩を製造することができる。

【実施例】

[0137]

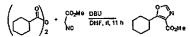
以下、本発明について、実施例を挙げて詳述するが、本発明はこれらの実施例になんら 限定されるものではない。

[0138]

参考例1 2-シクロヘキシルー1-メトキシカルボニルー2-オキソーエチルーアンモニウム;クロリドの製造

[0139]

【化14】



[0140]

メチルイソシアノエート (3.11 g)とシクロヘキサン酸無水物 (8.20 g, 1.1 eq) の DMF (10.0 mL)溶液にDBU (4.7 mL, 1.0 eq) を0℃下で滴下した。11時間室温で攪拌した後、反応液を水で希釈し、n-ヘキサンー酢酸エチル(5:1)で抽出を行なった。有機層を分離し、飽和食塩水で洗浄後、1mol/L塩酸,飽和炭酸水素ナトリウム水及び飽和食塩水の順で洗浄した後、無水硫酸ナトリウムで乾燥を行った。沈殿物をろ過した後、ろ液を減圧下濃縮した。得られた粗物をn-ヘキサン - 酢酸エチルで再結晶を行い、生成物(5.00 g, 75 %)を得た。

[0141]

m.p. 97.5 - 101℃

IR (KBr) 2931, 2852, 1719, 1599, 1199 cm^{-1} ;

 1 H NMR (400 MHz, CDCl₃) δ 1.26 -1.89 (m, 10H, cyclohexyl - CH₂),3.45 - 3.48 (m, 1H, cyclohexyl - H),3.91 (s, 3H, CO₂ CH₃),7.74 (s, 1H, OCHN);

¹³C NMR (100 MHz, CDCl₃) δ 25.7,25.9, 30.6, 35.4, 51.9, 125.2, 148.6, 162.6, 164.1;

HRMS (FAB, NBA) calcd for $C_{11}H_{16}NO_3$: 210.1130 (M⁺ +1). Found: 210.1119.

[0142]

【化15】

[0143]

オキサゾール (10 mmol)を conc. 塩酸(5.0 mL)とメタノール(15.0 mL)に溶解した。 溶液を50℃で 4 時間攪拌した。その後、反応液を室温まで冷却し、濃縮した。残渣をジエチルエーテル中粉砕し、 α -アミノ- β -ケトエステルをろ取した。この固体を次工程にそのまま用いた。(収率:6 7 %)

[0144]

IR (KBr) 2931,2856, 1752, 1719, 1560, 1508, 1458, 1276, 1144 cm⁻¹; ¹HNMR (400 MH z, CDCl₃) δ 1.19 - 1.50 (m, 5H, cyclohexyl - H), 1.66 - 1.82 (m, 4H, cyclohexyl - H), 2.18 - 2.20 (m, 1H, cyclohexyl - H), 2.90 - 2.95 (m, 1H, cyclohexyl - H),



3.91 (s, 3H, CO_2CH_3), 5.50 (s, $COCHNH_3$), 8.92 (br, $COCHNH_3$); ^{13}C NMR (100MHz, CDC_{13}) δ 25.0, 25.6, 25.7, 27.4, 29.2, 48.4, 54.2, 60.3, 163.8,201.0; HRMS (FAB, NBA) calcd for $C_{10}H_{18}NO_3$:200.1287 (M⁺ - Cl). Found: 200.1282.

[0145]

参考例2 1-メトキシカルボニル-3-メチル-2-オキソーブチル-アンモニウム; クロリドの製造

[0146]

【化16】

[0147]

参考例1と同様にして対応するオキサゾールから目的化合物を得た。(収率:79%)

[0148]

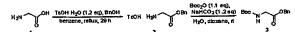
IR (KBr) 2979, 2642, 1751, 1720, 1508, 1438, 1387, 1275, 1234, 1013 cm $^{-1}$; ¹HNMR (400 MHz, CD₃OD) δ 1.12 (d, J = 6.4 Hz, 3H, (CH₃)₂CH), 1.24 (d, J = 7.2 Hz, 3H, (CH₃)₂CH), 3.19 -3.28 (sep, J = 7.2 Hz, 1H, (CH₃)₂CH), 3.92 (s, 3H, CO₂CH₃); ¹³C N MR(100 MHz, CD₃OD) δ 17.7, 19.1, 39.8, 54.6, 165.3, 203.6; HRMS (FAB, NBA) calcd for C₇H₁₄NO₃: 160.0974 (M⁺ - C1). Found: 160.0973.

[0149]

参考例3 t - ブトキシカルボニルアミノ酢酸 ベンジルエステルの製造

[0150]

【化17】



[0151]

グリシン(35.0g)、ベンジルアルコール(231 mL)、トシル酸(106 g, 1.2 eq)のベンゼン(469 mL)溶液を共沸脱水条件下で29時間加熱還流させた。反応液を室温まで冷却した。固体をろ取し、ジエチルエーテルで洗浄し、目的物 2 (168g)を得た。この固体を精製なしに次工程に使用した。中間体 2 (168 g)をジオキサンー水に溶解し、炭酸水素ナトリウム(47 g, 1.2eq)、t-ブチルオキシカルボニル酸無水物(112 g, 1.1 eq)を加えた。3時間攪拌した後、 濃縮した。残渣を1mol/L硫酸水素ナトリウム水溶液で洗浄し、酢酸エチルで3回抽出した。有機層は飽和炭酸水素ナトリウム水溶液で洗浄し、無水硫酸ナトリウムで乾燥し、ろ過濃縮した。残渣は、ジエチルエーテルーへキサンで晶析を行い、目的物3 (1st 54.3 g, 2nd 51.2 g, 3rd 7.9 g; total 113.4 g, 427 mmol, 92 %)を得た。

[0152]

¹H NMR (400 MHz, CDCl₃) δ 1.45(s, 9H, (CH₃)₃C), 3.96 (d, J = 5.7 Hz, 2H, CH₂NH), 5.00 (br. 1H, CH₂NH), 5.18 (s, 2H, CH₂Ph), 7.34 - 7.38 (m, 5H, Ar - H)

[0153]

参考例4 4 a の製造

[0154]

【化18】

[0155]

原料 3 (1.06 g, 4.00 mmol) をテトラヒドロフラン (8.0 mL) に溶解し -78^{\circ} に冷却した。 続いてカリウムへキサメチルジシラジド(0.5 M soln. 9.0 mL, 1.1 eq) を10分かけて加えた。同温度で2時間攪拌した。さらにイソブチリルクロリド(0.46 mL, 1.1eq)を加え同温度でさらに3時間攪拌した。 反応液を飽和塩化アンモニアでクエンチ、酢酸エチルーヘキサン (5:1) で3回抽出した。有機層を飽和炭酸水素ナトリウムで洗浄、硫酸ナトリウムで乾燥し、ろ過濃縮した。残渣はシリカゲルクロマト(ヘキサン:酢酸エチル =



3:1) を行い目的物 4a(1.26 g, 94 %) を無色油状物として得た。

[0156]

IR (neat) 2978,1747, 1698, 1457, 1370, 1216, 1148, 1028 cm⁻¹; ¹H NMR (400 MHz, CD Cl₃) δ 1.17 (d, J = 6.8 Hz, 6H, (CH₃)₂CH),1.44 (s, 9H, (CH₃)₃C), 3.72 - 3.76 (m, 1H, (CH₃)₂CH),4.48 (s, 2H, CH₂N), 5.16 (s, 2H, CH₂Ph),7.32 - 7.36 (m, 5H, Ar - H); ¹³C NMR (100 MHz, CDCl₃) δ 19.6, 27.8, 34.6, 45.6, 66.9, 83.7, 128.4, 128.5, 135.4, 152.1, 168.9, 180.2; HRMS (FAB, NBA) calcd for C₁₈H₂₆NO₅: 336.1811 (M⁺ + 1). Found: 336.1811.

[0157]

参考例 5-9 4b-4fの製造

参考例4と同様の方法により4b-4fを製造した。

[0158]

【化19】

[0159]

表 1

参考例 No.	R	反応時間 (時間)	生成物	収率 (%)
5 6 7 8	n-P r $t-B u$ $c-P e n$ $c-H e x$ $c-H e p$	3 1 2 2 1 2	4 b 4 c 4 d 4 e 4 f	8 8 9 3 7 1 9 4 9 7

[0160]

4 b 無色油状物

IR (neat) 2969,1747, 1456, 1370, 1216, 1149, 1031 cm $^{-1}$; 1 H NMR (400 MHz,CDCl $_{3}$) δ 0.96 (t, J= 7.3 Hz, 3H, CH $_{3}$ CH $_{2}$ CH $_{2}$ CO), 1.43 (s,9H, (CH $_{3}$) $_{3}$ C), 1.65 – 1.70 (m, 2H, CH $_{3}$ CH $_{2}$ CH $_{2}$ CO),2.91 (t, J= 7.3 Hz, 2H, CH $_{3}$ CH $_{2}$ CH $_{2}$ CO),4.50 (s, 2H, CH $_{2}$ N), 5.17 (s, 2H, CH $_{2}$ Ph),7.32 – 7.36 (m, 5H, Ar – H); 13 C NMR (100 MHz, CDCl $_{3}$) δ 13.7, 18.4, 27.8, 39.8, 45.3,66.9, 83.7, 128.4, 128.4, 128.6, 135.4, 152.2, 169.0, 175.6; HR MS (FAB, NBA) calcd for C $_{18}$ H $_{26}$ NO $_{5}$: 336.1811 (M $^{+}$ +1). Found: 336.1804.

[0161]

4 c 無色油状物

IR (neat) 2974, 1747, 1694, 1456, 1336, 1148, 1010 cm⁻¹; ¹HNMR (400 MHz, CDCl₃) δ 1.35 (s, 9H, (CH₃)₃ CCON), 1.44 (s, 9H, (CH₃)₃ COCO), 4.33 (s, 2H, CH₂N), 5.16 (s, 2H, CH₂Ph), 7.33 - 7.36 (m, 5H, Ar - H); ¹³C NMR (100 MHz, CDCl₃) δ 27.1, 27.8, 2 7.9, 43.1,48.3, 66.0, 66.9, 83.2, 127.6, 127.9, 128.3, 128.3, 128.4, 128.5, 135. 4, 152.7,169.1, 184.6; HRMS (FAB, NBA) calcd for C₁₉H₂₈NO₅:350.1967 (M⁺ + 1). Fo und: 350.1976.

[0162]

4 d

IR (KBr) 2971, 2871, 1746, 1695, 1455, 1370, 1148, 1048, 1027 cm⁻¹; ¹H NMR (400 M Hz, CDCl₃) δ 1.43 (s, 9H, (CH₃)₃ COCO), 1.53 - 1.94 (m, 8H, cyclopentyl - CH₂), 3. 80 - 3.85 (m, 1H, cyclopentyl - CH), 4.49 (s, 2H, CH₂N), 5.16 (s, 2H, CH₂Ph), 7.31 - 7.37 (m, 5H, Ar - H); ¹³C NMR (100 MHz, CDCl₃) δ 25.9, 27.8, 30.4, 45.2, 45.7, 66.9, 83.5, 128.4, 128.5, 135.4, 152.1, 169.0, 179.1; HRMS (FAB, NBA) calcd for C



20H28NO5: 362.1967 (M++1). Found: 362.1932.

[0163]

4 e 白色固体

IR (KBr) 2931, 2853, 1737, 1691, 1450, 1368, 1323, 1193, 1146 cm⁻¹; ¹H NMR (400 M Hz, CDCl₃) δ 1.21 - 1.42 (m, 4H, cyclohexyl - CH₂), 1.67 - 1.80 (m, 4H, cyclohexyl - CH₂), 1.91 - 2.05 (m, 2H, cyclohexyl - CH₂), 3.46 (tt, J = 3.3, 11.2 Hz, CHCO N), 4.47 (s, 2H, CH₂N), 5.15 (s, 2H, CH₂Ph), 7.32 - 7.36 (m, 5H, Ar - H); ¹³ CNMR (100 MHz, CDCl₃) δ 25.7, 25.9,27.8, 29.7, 44.4, 45.7, 66.9, 83.6, 128.4, 128.5, 135.4, 152.1, 169.0, 179.1; HRMS (FAB, NBA) calcd for C₂₁H₃₀NO₅: 376.2124(M⁺ + 1). Found: 376.2148.

[0164]

4 f 白色固体

IR (neat) 2929, 2857, 1741, 1698, 1457, 1339, 1149, 1043 cm $^{-1}$; H NMR (400 MHz, C DCl₃) δ 1.44 - 1.66 (m, 17H, cycloheptyl - H, (CH₃)₃C), 1.72 -1.78 (m, 2H, cycloheptyl - H), 1.90 -1.97 (m, 2H, cycloheptyl - H), 3.64 -3.71 (m, 1H, CHCON), 4.47 (s, 2H, CH₂CO₂CH₂Ph), 5.16 (s, 2H, CH₂CO₂CH₂Ph), 7.30 - 7.38 (m, 5H, Ar - H); 13 CNMR (100 MHz, CDCl₃) δ 26.5, 27.8, 31.6, 45.2, 45.6, 66.9, 83.5, 128.4, 128.5, 135.4, 152.1, 169.0, 180.1; HRMS(FAB, NBA) calcd for C₂₂H₃₂NO₅: 390.2280 (M $^+$ + 1). Found: 390.2266.

[0165]

参考例10 5aの製造

[0166]

【化20】

[0167]

4aのテトラヒドロフラン溶液を -78 $\mathbb C$ に冷却した。 この溶液に1,3-ジメチル-3,4,5,66-テトラヒドロ-2-ピリミジノン (2.0 eq)とリチウムヘキサメチルジシラジド(2.5 eq)を10分間かけて加えた。同温度で 2 時間攪拌した後、反応液を飽和塩化アンモニア水でクエンチした。酢酸エチルーヘキサン (5:1) で 3 回抽出をおこなった。有機層を飽和炭酸水素ナトリウム水で洗浄、硫酸ナトリウムで乾燥し、ろ過濃縮した。残渣はシリカゲルクロマトを行い目的物 5 a を無色油状物として得た。(収率:8 5 %)

[0168]

IR (neat) 3431, 2977, 1759, 1715, 1496, 1367, 1251, 1162 cm⁻¹; ¹H NMR (400MHz, CD Cl₃) δ 0.99 (d, J = 6.8 Hz, 3H, (CH₃)₂CH), 1.14 (d, J = 7.1 Hz, 3H, (CH₃)₂CH), 1. 44(s, 9H, (CH₃)₃C), 2.94 - 2.99 (m, 1H, (CH₃)₃CH), 5.15 - 5.29 (m, 3H, CHNH, CH₂P h), 5.73 (d, J = 7.0 Hz, 1H, CHNH), 7.31 - 7.38 (m, 5H, Ar - H); ¹³CNMR (100 MHz, CDCl₃) δ 17.4, 18.7, 28.2, 38.4, 62.1, 68.0, 80.5, 128.4, 128.6, 134.7, 154.8, 1 66.7, 205.1; HRMS(FAB, NBA) calcd for C₁₈H₂₆NO₅:336.1811 (M⁺ + 1). Found: 336.18 16.

[0169]

参考例 1 1 - 1 5 5 b - 5 f の製造

参考例10と同様の方法により5b-5fを製造した。

[0170]

【化21】

表 2

参考例 No.	R	反応時間 (時間)	生成物	収率 (%) ————
11 12 13 14 15	n - P r t - B u c - P e n c - H e x c - H e p	1.5 2 2 6	5 b 5 c 5 d 5 e 5 f	8 7 7 5 9 0 8 4 9 9

[0172]

5 b 無色油状物

IR (neat) 3432,2970, 1759, 1715, 1496, 1368, 1253, 1163 cm-1; 1 H NMR (400 MHz, C DC1₃) δ 0.83 (t, J = 7.3 Hz, 3H, CH₃ CH₂ CH₂ CO), 1.44 (s, 9H, (CH₃)₃ CO), 1.52 - 1.62 (m, 2H, CH₃ CH₂ CH₂ CO), 2.52 - 2.60 (m, 2H, CH₃ CH₂ CH₂ CO), 5.05 (d, J = 7.1 Hz, 1H, CHNH), 5.16 (d, J = 12.3 Hz, 1H, CH₂Ph), 5.29 (d, J = 12.3 Hz, 1H, CH₂Ph), 5.74 (d, J = 6.8 Hz, 1H, CHNH), 7.31 - 7.38 (m, 5H, Ar - H); 13 CNMR (100MHz, CDC1₃) δ 1 3.4, 16.8, 19.5, 27.8, 28.2, 42.4, 63.7, 68.0, 80.5, 128.4, 128.6, 134.7, 154.9, 166.6, 201.0; HRMS (FAB, NBA) calcd for C_{18} H₂₆ NO₅:336.1811 (M⁺ + 1). Found: 336. 1788.

[0173]

5 c IR (neat) 3376,2977, 1758, 1713, 1504, 1368, 1326, 1252, 1162 cm $^{-1}$; ¹HNMR (400 MHz, CDCl₃) δ 1.18 (s, 9H, (CH₃)₃CCOCH), 1.43 (s, 9H, (CH₃)₃COCO), 5.15 (d, J = 12.3 Hz, 1H, CH₂Ph), 5.20 (d, J = 12.3 Hz, 1H, CH₂Ph), 5.52 (m, 2H, COCHNH), 7.29–7.37 (m, 5H, Ar – H); ¹³C NMR (100 MHz, CDCl₃) δ 26.1, 28.2, 44.7, 57.0, 67.7, 80

.6, 128.3, 128.5, 128.6, 154.8, 167.6, 208.0; HRMS (FAB, NBA) calcd for C₁₉H₂₈NO₅:350.1967 (M⁺ + 1). Found: 350.1913.

[0174]

5 d IR (neat) 3430, 2967, 2871, 1759, 1714, 1489, 1367, 1254, 1162 cm⁻¹; H NMR (400 MHz, CDCl₃) δ 1.34 - 1.94 (m, 17H, cyclopentyl - CH₂, (CH₃)₃CO), 3.14 - 3.18 (m, 1H, CHCOCHNH), 5.13 - 5.17 (m, 2H, CHNH, CH₂Ph), 5.29 (d, J = 12.0 Hz, 1H, CH₂Ph), 5.76 (d, J = 6.8 Hz, 1H, CHNH), 7.35 - 7.38 (m, 5H, Ar - H); ¹³CNMR (100 MHz, CDCl₃) δ 26.0, 26.0, 28.2, 28.5, 30.3, 48.8, 63.5, 67.9, 80.5, 128.6, 134.8, 154.8, 166.8, 203.7; HRMS (FAB, NBA) calcd for C₂0H₂8NO₅: 362.1967 (M⁺ + 1). Found: 362

[0175]

5 e

. 1933.

IR (neat) 3431, 2978, 2932, 2856, 1755, 1713, 1495, 1453, 1368, 1337, 1251, 1161 cm⁻¹; ¹H NMR (400 MHz, CDCl₃) δ 1.05 - 1.92 (m, 19H, cyclohexyl - CH₂, (CH₃)₃CO), 2.64 - 2.68 (m, 1H, CHCOCHNH), 5.14 (d, J = 12.1 Hz, 1H, CH₂Ph), 5.18 (d, J = 7.1 Hz, 1H, CHNH), 5.31 (d, J = 12.1 Hz, 1H, CH₂Ph), 5.73 (d, J = 7.1 Hz, 1H, CHNH), 7.31 - 7.36 (m, 5H, Ar - H); ¹³C NMR (100 MHz, CDCl₃) δ 25.0, 25.5, 25.7, 27.6, 28.3, 29.1, 48.2, 62.3, 68.0, 80.5, 128.6, 128.7, 134.8, 154.9, 166.7, 204.0; HRM S (FAB, NBA) calcd for C₂₁H₃₀NO₅:376.2124 (M⁺ + 1). Found: 376.2118.

[0176]

5 f



COCHNH), 5.30 (d, 1H, J = 12.0 Hz, CH₂Ph), 5.73 (d, J = 6.8 Hz, 1H, CHCOCHNH), 7. 35 - 7.38 (m, 5H, Ar - H); 13 C NMR (100 MHz, CDCl₃) δ 26.2, 26.5, 28.0, 28.1, 28.2, 29.1, 30.3, 49.4, 62.4, 67.9, 80.4, 128.5, 128.6, 134.8, 154.9, 166.7, 204.4; H RMS (FAB, NBA) calcd for C₂2H₃2NO₅:390.2280 (M⁺ + 1). Found: 390.2263.

[0177]

参考例16 6aの製造

【0178】 【化22】

[0179]

5 a を4mol/L塩酸-ジオキサンに溶解した。室温下、44時間攪拌した後、反応液を濃縮した。残渣をジエチルエーテル中粉砕し、目的物 6 a を 5取した。この固体を次工程にそのまま用いた。(収率:97%)

[0180]

IR (KBr) 3403, 2972, 2936, 2654, 1762, 1736, 1523, 1267 cm⁻¹; ¹H NMR (400 MHz, CDC $_{13}$) δ 0.96 (d, J= 6.4 Hz, 3H, (CH₃)₂CH), 1.22 (d, J= 6.7 Hz, 3H, (CH₃)₂CH), 3.03 -3.09 (m, 1H, (CH₃)₂CH), 5.24 (d, J= 11.6 Hz, 2H, CH₂ Ph), 5.33 (d, J= 12.0 Hz, 2H, CH₂Ph), 5.47 (s, 1H, COCHN), 7.32 - 7.38 (m, 5H, Ar - H), 9.00 (br); ¹³C NM R (100 MHz, CDCl₃) δ 17.1, 18.9, 38.9,60.4, 67.0, 69.2, 128.6, 128.7, 128.8, 134.1, 163.3, 202.1; HRMS (FAB, NBA) calcd for $C_{13}H_{18}NO_3$: 236.1287 (M⁺ -Cl). Found: 236.1272.

[0181]

参考例17-21 6b-6fの製造

参考例16と同様の方法により6b-6fを製造した。

[0182]

【化23】

[0183]

表 3

参考例 No.	R	反応時間 (時間)	生成物	収率 (%)
17 18 19 20 21	n - P r t - B u c - P e n c - H e x c - H e p	48 62.5 63 72 24	6 b 6 c 6 d 6 e 6 f	80 91 定量量的 定量量的

[0184]

6 h

IR (KBr) 2968, 2935, 2599, 1750, 1725, 1459, 1280, 1226, 1147 cm $^{-1}$; ¹HNMR (400 MHz, CD₃OD) δ 0.84 (t, J= 7.6 Hz, 3H, CH₃CH₂CH₂CO), 1.50 - 1.62 (m, 2H, CH₃CH₂CH₂CO), 2.64 - 2.80 (m, 2H, CH₃CH₂CH₂CO), 5.32 (d, J= 11.6 Hz, 1H, CH₂Ph), 5.41 (d, J= 12.0 Hz, 1H, CH₂Ph), 7.36 - 7.46 (m, 5H, Ar - H); ¹³C NMR (100 MHz, CD₃OD) δ 13.6, 17.6, 43.4, 70.2, 129.8, 130.1, 135.8, 164.7, 199.2; HRMS (FAB, NBA) calcd for C₁₃H₁₈NO₅:236.1287 (M $^+$ - C1). Found: 236.1275.

[0185]



6 c IR (KBr) 2971, 2900, 2867, 1747, 1718, 1543, 1508, 1265, 1239 cm⁻¹; 1 H NMR (400 M Hz, CDCl₃) δ 1.20 (s, 9H, (CH₃)₃C), 5.25 (s, 2H, CH₂Ph), 5.62 (s, 1H, COCHN), 7.30 – 7.37 (m, 5H, Ar – H), 9.00 (br); 13 C NMR (100MHz, CDCl₃) δ 26.6, 44.9, 56.7, 69.2, 128.6, 128.7, 128.9, 134.0, 163.6, 204.4; HRMS(FAB, NBA) calcd for C₁₄H₂₀N O₃: 250.1443 (M⁺ – Cl). Found: 250.1438.

[0186]

6 d IR (KBr) 2951, 1746, 1720, 1508, 1458, 1269, $1207cm^{-1}$; ¹H NMR (400 MHz, CDCl₃) δ 1.44 - 2.02 (m, 8H, cyclopentyl - H), 1.96 - 2.02 (m, 1H, cyclopentyl - H), 5.24 (d, J = 12.0 Hz, 1H, CH₂Ph), 5.33 - 5.36 (m, 2H, CH₂Ph, COCHNH₃), 7.26 - 7.39 (m, 5H, Ar - H), 9.00 (br, COCHNH₃); ¹³ CNMR (100 MHz, CDCl₃) δ 25.9, 26.0, 28.3, 30 .6, 49.1, 61.6, 69.2, 128.6, 128.7, 128.8, 134.2, 163.3, 200.7; HRMS (FAB, NBA) c alcd for C₁5 H₂0 NO₃: 262.1443 (M⁺ - Cl). Found: 262.1445.

[0187]

6 e

IR (KBr) 2931, 2854, 1747, 1719, 1509, 1266 cm⁻¹; H NMR (400 MHz, CDCl₃) δ 0.9 7 - 1.36 (m, 5H, cyclohexyl - H),1.48 - 1.62 (m, 3H, cyclohexyl - H),1.69 - 1.72 (m, 1H, cyclohexyl - H),2.11 - 2.14 (m, 1H, cyclohexyl - H),2.78 (tt, J = 3.2, 11.6 Hz, 1H, cyclohexyl - H), 5.21 (d, J = 12.0 Hz, 1H, CH₂Ph), 5.38 (d, J= 12.0 Hz, 1H, CH₂Ph),5.53 (s, 1H, COCHNH₃),7.30 - 7.39 (m, 5H, Ar - H), 8.93 (br, COCHNH₃); H₃ CNMR (100 MHz, CDCl₃) δ 24.9, 25.5, 25.6, 27.2, 29.1, 48.3, 60.6, 69.2, 1 28.6, 128.8, 128.9, 134.2,163,3, 200.8; HRMS (FAB, NBA) calcd for C₁ 6H₂ 2NO₃:276. 1600 (M⁺ - Cl). Found: 276.1602.

[0188]

6 f

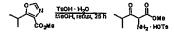
IR (KBr) 2927, 2624, 1746, 1720, 1509, 1459, 1281, 1198, 1119 cm⁻¹; ¹H NMR (400 M Hz, CDCl₃) δ 1.15 - 1.18 (m, 1H, cycloheptyl - H), 1.45 - 1.57 (m, 10H, cycloheptyl - H), 2.93 - 2.97 (m, 1H, cycloheptyl - H), 5.21 (d, J = 12.0 Hz, 1H, CH₂Ph), 5.38 (d, J = 13.2 Hz, 1H, CH₂Ph), 5.40 (s, 1H, COCHNH₃), 7.31 - 7.39 (m, 5H, Ar - H), 9.01 (br, COCHNH₃); ¹³C NMR (100 Hz, CDCl₃) δ 26.1, 26.5, 27.9, 28.1, 28.8, 30.3, 49.5, 60.7, 69.2, 128.6, 128.8, 128.9, 134.2, 163.3, 201,1; HRMS (FAB, NBA) cacld for C₁₇H₂₄NO₃:290.1756 (M+ - Cl). Found: 290.1765.

[0189]

参考例22

[0190]

【化24】



[0191]

オキサゾール (102.8 mg) のメタノール (3.0 mL) 溶液にトルエンスルホン酸 1 水和物(23 0.0 mg)を加え、2.5 時間加熱還流する。次にこの溶液を濃縮したのち、ジエチルエーテル中で粉砕する。この粗物を精製せずに次工程に進めた。

[0192]

¹H NMR (400 MHz, CDC1₃) δ 1.03 (d, J = 6.8 Hz, 3H, (CH₃)₂CH), 1.11 (d, J = 7.1 Hz, 3H, (CH₃)₂CH), 2.34 (s, 3H, Ar - CH₃), 3.06 (sep, J = 7.0 Hz, 1H, (CH₃)₂CH), 5 .36 (s, 1H, CHNH₂), 7.13 (d, J= 8.1 Hz, 2H, Ar - H), 7.70 (d, J = 8.2 Hz, 2H, Ar - H), 8.46 (s, 2H, CHNH₂)

[0193]

参考例23 6gの製造



【0194】 【化25】

CN TO TEA ON MOOTH HILL-Grame Ph NH3 CT

[0195]

[0196]

 1 H-NMR (400 MHz CDCl₃): δ 3.96 (s, 3H), 7.45 \sim 7.53 (3H, m, Ar-H), 7.92 (s, 1H, oxa zole-H), 8.00 \sim 8.12 (2H, m, Ar-H)

FT-IR ν_{max} (KBr):3108, 1717, 1582, 1561, 1516, 1495, 1433, 1354, 1325, 1312, 1221, 1195, 1109,1087, 1068, 1010, 936, 767, 688.

[0197]

オキサゾール化合物 (2.26 g, 11.1 mmol) を4mol/L 塩酸ージオキサン (18 ml) とメタノール (18 ml) に溶解し60 \mathbb{C} で24 時間 攪拌した。その溶液を室温まで冷却し、濃縮した。残渣をメタノールに溶解し、再度濃縮した。この操作を 5 回繰り返し、完全に残留塩酸を除去した。その固体をエーテル洗浄、ろ取した。酢酸エチルとメタノールで再結晶を行い、化合物 6 g (1.42 g, 6.2mmol, 56%) を無色固体として得た。

[0198]

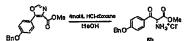
 $^{1}\text{H-NMR}$ (400 MHz CD₃0D): δ 3.77 (s,3H), 7.60 (t, J =7.6 Hz, 2H), 7.77 (t,J =7.6 Hz, 1H) 8.17 (dd, J =1.6, 8.8 Hz 2H); $^{13}\text{C-NMR}(100 \text{ M Hz}, \text{CD}_{3}\text{OD})$: δ (ppm) 54.6, 130.1 , 131.0, 134.9, 136.3, 165.4,190.0; FABMS (NBA) m/z: 194 (M-Cl^-)+; FT-IR ν max (KBr): 3441, 2840, 1739, 1688, 1597, 1274,1217, 684

[0199]

参考例24 6hの製造

[0200]

【化26】



[0201]

参考例23と同様にして対応するオキサゾールから目的化合物(6h)を得た。

[0202]

¹H-NMR (400 MHz CD₃0D): δ 3.77(s, 3H), 5.23 (s, 2H), 6.04 (s, 1H), 7.1~7.5 (m, 7H, Ar-H), 8.14 (d, J =7.2 Hz, 2H); ¹³C-NMR (100M Hz, CD₃0D): δ (ppm) 54.5,584 , 71.5, 116.2, 127.8, 128.7, 129.3,129.7, 133.6, 137.7, 165.8, 166.0, 187.9; FAB MS (NBA) m/z: 300 (M-Cl⁻)⁺; FT-IR ν max (KBr): 3445, 2969, 1759, 1685, 1603, 1509, 1276, 1254,1222, 1176, 1075, 832, 743, 697.

[0203]

参考例 2 5 - 2 9 6 i - 6 mの製造

[0204]

【化27】

R NH3+CI

[0205]



参考例23と同様な操作を行うことにより6i-6mを製造した。

[0206]

尚、各化合物の構造は、以下の通りとなる。

6 i: R=p-メチルフェニル

 $6 j : R = m - \lambda + \mu \tau + \mu \tau$

 $6 k : R = \beta - \tau \tau$

61:R=2-フリル

6 m: R=p-プロモフェニル

[0207]

各化合物の機器データを以下に示す。

[0208]

6 i

¹H-NMR (400 MHz CD₃0D): δ 2.47 (s, 3H), 3.77 (s, 3H), 6.09 (s, 1H), 7.42 (2H, d, J= 8.0 Hz), 8.05 (2H, d, J= 8.0 Hz; ¹³C-NMR (100M Hz, CD₃0D): δ 21.8, 54.5, 58. 7, 130.7, 131.2, 132.4, 148, 0.165.6, 189.3; FT-IR ν max (KBr): 2995, 2826, 2626, 1739, 1685, 1604,1505, 1434, 1276, 1220, 1179, 1074, 968, 942, 863.

[0209]

6 j

¹H-NMR (400 MHz CD₃OD): δ 2.45 (s, 3H), 3.81 (s, 3H), 6.11 (s, 1H), 7.4~7.6 (2H, Ar-H), 7.9~8.0 (2H, Ar-H); ¹³C-NMR (100 M Hz, CD₃OD): δ 21.3, 54.6, 58.8, 128.3, 130.0, 131.2, 135.0, 137.0, 140,3, 165.5, 190.1; FT-IR ν_{max} (KBr): 3004, 2813, 2626, 1737, 1685, 1602, 1511, 1434, 1275, 1228, 1168, 1072, 948, 889, 866, 785, 685.

[0210]

6 k

 $^1\text{H-NMR}$ (400 MHz CD₃0D): δ 3.75 (s, 3H), 6.30 (s, 1H), 7.6~7.75(2H, Ar-H), 7.9~8.15 (4H, ArH), 8.82 (1H, s, Ar-H); $^{13}\text{C-NMR}$ (100 MHz, CD₃0D): δ 54.6, 58.7, 125. 0, 128.5, 129.0, 129.9, 131.0, 131.2,132.2, 133.8, 134.3, 137.8, 165.6, 189.9; F T-IR ν_{max} (KBr): 3440,2819, 1739, 1688, 1622, 1594, 1502, 1434, 1280, 1236, 1174, 1008, 937, 811, 760.

[0211]

6 1

 $^1\text{H-NMR}$ (400 MHz CD₃0D): δ 3.82 (s, 3H), 5.78 (s, 1H), 6.80 (1H, dd, J= 1.6, 4.0 Hz, Ar-H), 7.71 (1H, d, J= 4.0 Hz, Ar-H), 8.00 (1H, d, J= 1.6 Hz, Ar-H); $^{13}\text{C-NMR}(1.00 \text{ M} \text{Hz}, \text{CD}_3\text{OD})$: δ 54.7, 58.4, 114.6, 124.1, 151.2, 151.3, 165.5,177.1; FT-IR ν m ax (KBr): 3430, 2973, 2637, 1752, 1679, 1590, 1570,1504, 1464, 1404, 1285, 1252, 1155, 1088, 1079, 1036, 1023, 991, 951, 910, 876,841, 769.

[0212]

6 m

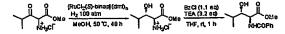
¹H-NMR (400 MHz CD₃OD): δ 3.78(s, 3H), 6.11 (s, 1H), 7.79 (2H, Ar-H), 8.05 (2H, Ar-H); ¹³C-NMR(100 M Hz, CD₃OD): δ 547, 589, 131.5, 132.6, 133.4, 133.9, 165.2,1 89.3; FT-IR ν_{max} (KBr): 2810, 1738, 1689, 1586, 1497, 1433, 1405,1275, 1213, 117 6, 1134, 1175, 966, 940, 864, 816, 764, 676.

[0213]

実施例1 β-ヒドロキシーα-アミノカルボン酸誘導体の製造

[0214]

【化28】



[0215]



アルゴン雰囲気下、 $[RuCl_2(C_6H_6)]_2(10.1mg)$ と(S)-BINAP (25.3mg)および DMF $400\,\mu$ Lをシュレンクチューブ中で混合した。この混合溶液を脱気後、 $100\,C$ で $10分攪拌した。室温にした後、赤茶色の触媒は<math>50\,C$ 2.5 時間で減圧乾燥した。参考例 2 で製造した 1-メトキシカルボニルー 3-メチルー 2-オキソーブチルーアンモニウム;クロリド(169.2mg)をメタノール(2.0mL) に溶解、脱気後、触媒溶液にアルゴン置換したカニューラで加えた。(残渣はメタノール1.0mlで洗浄し、同様に加えた。)溶液は $50\,C$ 、水素(100 atm)中48時間攪拌した。それから反応液を濃縮することにより目的物を得た。

得られた粗物は、ベンゾイル化した後、機器分析することにより de 及び ee を決定した。 de は、 1H NMRにより決定し、 ee は、 1H NMRにより決定し、

[0216]

ベンゾイル化

得られた粗物をテトラヒドロフラン (1.7 nL) に溶解した。 続いてベンゾイルクロライド $(110 \mu\text{L})$ と トリエチルアミン $(380 \mu\text{L})$ を0℃で溶液に加えた。 室温で1時間攪拌後、反応液を水と酢酸エチルとヘキサンで反応停止を行った。つづいて分液後、有機層を1mo 1/L塩酸溶液で洗浄、炭酸水素ナトリウム水溶液で洗浄、無水硫酸ナトリウムで乾燥後、 ろ過、乾燥、濃縮を行った。続いてこの粗物をシリカゲルクロマトグラフ(酢酸エチル: n-ヘキサン = 1:3)で分取精製し、目的物(162.1 mg, 2 steps 71 %, de 98 %, 56 %ee)を 得た。

[0217]

HPLC analysis using CHIRALCEL OD-H and hexane/ i PrOH (85 : 15, 0.5 mL/min), Retention time for (2R, 3R) : 10.6 min, for (2S, 3S) : 15.6 min.

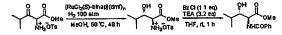
[α]_D²⁵ + 35.4 (0.99, CHCl₃); IR (neat)3417, 2962, 1747, 1633, 1538, 1455, 1372, 1062, 1011 cm⁻¹; ¹HNMR (400 MHz, CDCl₃) δ 1.02 (d, J = 6.8 Hz, 3H, (CH₃)₂CH), 1.05 (d, J = 6.6 Hz, 3H, (CH₃)₂CH), 1.77 (sep, J = 6.6 Hz, 1H, (CH₃)₂CH), 2.91 (d, J = 8.2 Hz, 1H, CHOH), 3.62 (dt, J = 3.3, 8.6 Hz, 1H, CHOH), 3.82 (s, 3H, CO₂CH₃), 4.97 (dd, J = 3.3, 7.3 Hz, 1H, CHNH), 7.14 (d, J = 6.6 Hz, 1H, NH), 7.44-7.4 (m, 2H, Ar - H), 7.52 - 7.56 (m, 1H, Ar - H), 7.82 - 7.85 (m, 2H, Ar - H); HRMS (FAB, NBA) calcd for C₁4H₂0NO₄:266.1392 (M⁺ + 1). Found: 266.1408.

[0218]

実施例2

[0219]

【化29】



[0220]

原料の塩酸塩を参考例 2 2 で製造したトシル酸塩に変え、触媒の使用量を 6 . 7 mol % と した以外は実施例 1 と同様の操作を行うことにより目的物を得た。(収率: 7 2 %(2 ステップ合計)、 d e : 9 4 %、 e e : 2 2 %)

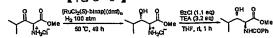
[0221]

実施例3-11 溶媒の効果

溶媒を種々変更した以外は実施例1と同様の操作を行うことにより、目的物を製造した。尚、触媒の使用量は、基質に対して3.8-4.6 mol %の範囲で行った。又、収率は2ステップの合計で示した。

[0222]

【化30】



[0223]

表 4

4	
.000000	
₹	

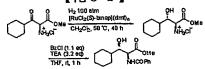
実施例 No.	溶媒	収率 (%)	d e (%)	e e (%)
3	MeOH/CH ₂ Cl ₂	8 0	> 9 9	7 0
4	CH ₂ Cl ₂	3 8	98	9 5
5	n-PrOH	6 9	98	6 9
6	n-PrOH/CH2Cl2	9 2	98	8 2
7	n-PrOH/THF	9 1	9 5	8 1
8	i-PrOH	8 1	98	8 1
9	i-PrOH/CH ₂ Cl ₂	7 2	9 5	8 0
10	2-BuOH	9 1	9 1	74
11	(CH ₂ OH) ₂	8 4	9 1	5 7

[0224]

実施例12

[0225]

【化31】



[0226]

基質を参考例 1 で製造した 2 ーシクロヘキシルー 1 ーメトキシカルボニルー 2 ーオキソーエチルーアンモニウム;クロリドに変え、溶媒を塩化メチレンに変えた以外は実施例 1 と同様の操作を行うことにより、目的物を得た。(収率:84%(2 ステップ合計)、0 e:0 5 %、0 e e 0 6 %)

[0227]

[α]_D²⁶ + 35.5 (1.07, CHCl₃); mp 94 - 97 °C; IR (KBr) 3545, 3493, 3281, 2927, 28 54, 1739, 1630, 1542, 1363, 1230, 1209 cm⁻¹; ¹H NMR (400 MHz, CDCl₃) δ 0.97 - 1.30 (m, 5H, cyclohexyl- H), 1.42 - 1.51 (m, 1H, cyclohexyl-H), 1.65 - 1.84 (m, 4H, cyclohexyl- H), 2.03 - 2.06 (m, 1H, cyclohexyl-H), 2.94 (d, J = 8.4 Hz, 1H, CHOH), 3.68 (dt, J = 3.2, 8.8 Hz, 1H, CHOH), 3.82 (s, 3H, CO₂CH₃), 4.97 (dd, J = 3.2, 7.6 Hz, 1H, CHNH), 7.18 (d, J = 7.2 Hz, NH), 7.44 -7.47 (m, 2H, Ar - H), 7.51 - 7.56 (m, 1H, Ar - H), 7.82 - 7.84 (m, 2H, Ar - H); HRMS (FAB, NBA) calcd for C₁₇H₂₄NO₄:306.1705 (M⁺ + 1). Found: 306.1724.

HPLC analysis using CHIRALCEL OD-H and hexane/ PrOH (85: 15, 0.5 mL/min), Retention time for (2R, 3R): 11.2 min, for (2S, 3S): 15.3 min.

[0228]

実施例 1 3

[0229]

【化32】

[0230]

アルゴン雰囲気下、 $[RuCl_2(C_6H_6)]_2(10.3 \text{ mg})$ と(S)-BINAP(27.3 mg)および DMF 400 μ Lを シュレンクチューブ中で混合した。この混合溶液を脱気後、100Cで10分攪拌した。室温にした後、赤茶色の触媒は50C 2.5 時間で減圧乾燥した。 6 a(271.8 mg) を塩化メチレン(2.5 mL) に溶解、脱気後、触媒溶液にアルゴン置換したカニューラで加えた。(残渣は塩化メチレンで0.5mlで洗浄し、同様に加えた。)溶液は50C、水素(100 atm)中



4 8 時間攪拌した。それから反応液を濃縮し、目的物を得た。

得られた粗物は、ベンゾイル化した後、機器分析することにより $de \ D$ $ee \ Ee$ を決定した。 $de \ dx^1H \ NMR$ により決定し、 $ee \ dx$ $ee \ dx$ $ee \ dx$

【0231】 【化33】

[0232]

ベンゾイル化

得られた粗物をテトラヒドロフラン (2.0~mL) に溶解した。続いてベンゾイルクロライド $(130\,\mu\text{L})$ とトリエチルアミン $(440~\mu\text{L})$ を0 $^{\circ}$ で溶液に加えた。室温で1時間攪拌後、反応液を水と酢酸エチルとヘキサンで反応停止を行った。続いて分液後、有機層を1mol/L 塩酸で洗浄、炭酸水素ナトリウム水溶液で洗浄、硫酸ナトリウムで乾燥後、ろ過、乾燥、濃縮を行った。続いてこの粗物をシリカゲルクロマトグラフ (酢酸エチル: n-ヘキサン = 1: 2) で分取精製し、目的物を得た。(収率:87%(2ステップ合計)、de: >99%、ee: 96%)

[0233]

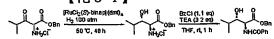
HPLC analysis using CHIRALCEL OD-H and hexane/i-PrOH (90 : 10, 0.5 mL/min), Ret ention time for (2R, 3R): 21.6 min, for (2S, 3S) : 30.3 min. [\$\alpha\$]_0^2 + \text{+}33.9(1.00, CDCl_3)\$; mp 95.5 - 96°C; IR (KBr) 3414, 2961, 2935, 2858, 174 9,1647, 1519, 1192, 1064 cm⁻¹; \text{\$^1\$H NMR}\$ (400 MHz, CDCl_3) \$\delta\$ 0.95 (d, J = 6.6 Hz, 3H, (CH_3)_2CH), 1.13 (d, J = 6.6 Hz, 3H, (CH_3)_2CH), 1.71 (m, 1H, (CH_3)_2CH), 2.92 (d, J = 8.4Hz, 1H, CHOH), 3.63 (dt, J = 3.1, 8.4 Hz, 1H, CHOH), 4.99(dd, J = 3.3, 7.3 Hz, 1H, CHNH), 5.23 (d, J = 12 Hz, 1H, CH_2-Ph), 5.29 (d, J = 12 Hz, 1H, CH_2-Ph), 7.14 (d, J = 7.3 Hz, 1H, CHNH), 7.34 - 7.39 (m, 5H, Ar - H), 7.43 - 7.47 (m, 2H, Ar - H), 7.52 - 7.56 (m, 1H, Ar - H), 7.81 - 7.83 (m, 2H, Ar - H); \text{\$^{13}\$C NMR}\$ (100 MHz, CDCl_3) \$\delta\$ 18.9, 19.0, 31.5, 56.2, 67.6, 78.9, 127.2, 128.4, 128.6, 128.7, 13 2.0, 133.4, 134.9, 167.5, 170.8; HRMS (FAB, NBA) calcd for C20H24NO4:342.1705 (M + 1). Found: 342.1682. Anal. Calcd for C20H23NO4:C, 70.36; H, 6.79; N, 4.10. Found: C, 70.26; H, 6.82; N, 4.06.

[0234]

実施例14-16 溶媒の効果

溶媒の種類及び触媒の使用量を変更した以外は実施例13と同様の操作を行うことにより、目的物を製造した。収率は2ステップの合計で示した。

【0235】 【化34】



[0236]

表 5

実施例	溶媒	触媒	収率	d e	e e
No.		(mol%)	(%)	(%)	(%)
14	n-PrOH	4.1	8 3	9 3	7 9
15	i-PrOH	4.2	9 4	9 5	7 6
16	Ph-Cl	6.2	8 5	6 7	8 6



実施例17-20 反応時間の検討

反応時間を変更した以外は実施例13と同様の操作を行うことにより、目的物を製造した。尚、触媒の使用量は、基質に対して3.9-4.1 mol%の範囲で行った。又、収率は2ステップの合計で示した。

【0238】 【化35】

[0239]

表 6

反応時間 (時間)	収率 (%)	d e (%)	e e (%)
2 4	8 8	> 9 9	9 2
1 3	8 1	> 9 9	98
6	8 4	> 9 9	98
3	5 5	8 9	98
	(時間) 2 4 1 3 6	(時間) (%) 2 4 8 8 1 3 8 1 6 8 4	(時間) (%) (%) 24 88 >99 13 81 >99 6 84 >99

[0240]

実施例21

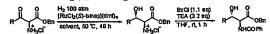
溶媒をジクロロエタン ($(CH_2C1)_2$) に変更し、反応温度を100 Cに変更し、反応時間を3 時間に変更した以外は実施例 13 と同様の操作を行うことにより、目的物を製造した。収率は2 ステップの合計で示した。(収率:90 %(2 ステップ合計)、de:93 %、ee:92 %)

.[0241]

実施例 2 2 - 3 2

基質及び溶媒を変更した以外は実施例13と同様の操作を行うことにより、目的物を製造した。収率は2ステップの合計で示した。

【0242】 【化36】



[0243]

表 7

実施例 No.	R	溶媒	収率 (%)	d e (%)	e e (%)
22	n - P r	CH ₂ Cl ₂	8 8	8 7	7 4
23	n - P r	CH ₂ Cl ₂ /n-PrOH	8 8	6 4	7 8
24	n - P r	n-PrOH	5 3	8 1	5 8
25	t - B u	n-PrOH	8 9	9 2	7 9
26	c - P e n	CH ₂ Cl ₂	7 7	9 6	5 6
27	c - P e n	CH ₂ Cl ₂ /n-PrOH	8 2	9 7	9 4
28	c - P e n	n-PrOH	8 5	9 5	9 5
29	c - H e x	CH ₂ Cl ₂	8 5	9 9	9 4
30	c - H e x	n-PrOH	8 0	9 6	5 4
31	c - H e p	CH ₂ Cl ₂	9 4	9 4	7 9
32	c - H e p	n-PrOH	8 6	9 4	9 7



R = n-Pr

[α]_D²² +14.8 (1.01, CHCl₃); mp 97 - 99°C; IR (KBr) 3354, 2958, 2867, 1737, 1629, 1578, 1534, 1254, 1221 cm⁻¹; ¹H NMR (400 MHz, CDCl₃) δ 0.85 (t, 3H, J = 7.2 Hz, 3H, CH₃CH₂CH₂), 1.28 - 1.56 (m, 4H, CH₃CH₂CH₂), 3.29 (d, J= 7.6 Hz, 1H, CHOH), 4.05 - 4.10 (m, 1H, CHOH), 4.93 (dd, J = 3.2, 6.8 Hz, 1H, CHNH), 5.21 (d, J = 12.4 Hz, 1H, CH₂Ph), 5.31 (d, J = 12.4 Hz, 1H, CH₂Ph), 7.14 (d, J = 6.8 Hz, 1H, CHNH), 7.26 - 7.56 (m, 8H, Ar - H), 7.82 - 7.84 (m, 2H, Ar - H); ¹³CNMR (100 MHz, CDC 1₃) δ 13.8, 18.9, 35.3, 58.3, 67.7, 73.1, 127.2, 128.2, 128.4, 128.7, 132.1, 133. 3, 134.9, 168.0, 170.3; HRMS (FAB, NBA) calcd for C₂0H₂4NO₄:342.1705 (M⁺ + 1). Found: 342.1699.

HPLC analysis using CHIRALCEL OD-H and hexane/ i PrOH (90 : 10,0.5 mL/min), Retention time for (2R, 3R) : 26.6 min, for (2S,3S) : 32.3 min.

[0245]

R = t-Bu

[α]_D ²² +23.9 (1.00, CHCl₃); IR (neat) 3373, 3064, 3033, 2958, 2908, 2872, 1731, 1644, 1538, 1487, 1177,1078 cm⁻¹; ¹H NMR (400 MHz, CDCl₃) δ 0.95 (s, 9H, (CH₃)₃C), 3.33 (d, J = 10 Hz, 1H, CHOH), 3.67 (dd, J = 3.2, 9.6 Hz, 1H, CHOH), 5.02 (dd, J = 3.2, 7.6 Hz, 1H, CHNH), 5.20 (d, J = 12.4 Hz, 1H, CH₂Ph), 5.24 (d, J = 12.4 Hz, 1H, CH₂Ph), 7.10 (d, J = 7.6 Hz, 1H, CHNH), 7.34 – 7.40 (m, 5H, Ar – H), 7.43 – 7.47 (m, 2H, Ar – H), 7.51 – 7.55 (m, 1H, Ar – H), 7.78 – 7.81 (m, 2H, Ar – H); ¹³C NMR (100 MHz, CDCl₃) δ 26.0,35.4, 54.5, 67.6, 81.1, 127.1, 128.5, 128.6, 1 32.0, 133.4, 134.6, 167.3, 171.1; HRMS (FAB, NBA) calcd for C₂₁H₂₆NO₄: 356.1862 (M + + 1). Found: 356.1827.

HPLC analysis using CHIRALPAK AD and hexane/'PrOH (90: 10, 1.0mL/min), Retention time for (2S, 3S): 17.8 min, for (2R, 3R): 26.8 min,

[0246]

R = Cyclopentyl

[α]_D ²⁴ +20.5(1.00, CHCl₃); mp 109 - 111°C; IR (KBr) 3414,3342, 2938, 2867, 1746, 1644, 1521, 1488, 1195 cm⁻¹; ¹HNMR (400 MHz, CDCl₃) δ 1.38 - 1.88 (m, 9H, cycl opentyl - H),2.95 (d, J = 8.0 Hz, 1H, CHOH), 3.78 (dt, J = 2.8, 8.8 Hz, 1H, CHOH), 4.92 (dd, J = 2.8, 7.2 Hz, 1H, CHNH), 5.21 (d, J = 12.4 Hz, 1H, CH₂Ph),5.31 (d, J = 12.4 Hz, 1H, CH₂Ph), 7.19 (d, J = 6.4 Hz, 1H, CHNH), 7.34 - 7.39 (m, 5H, Ar - H),7.43 - 7.47 (m, 2H, Ar - H), 7.51 -7.56 (m, 1H, Ar - H), 7.81 - 7.84 (m, 2H, Ar - H); ¹³C NMR(100MHz, CDCl₃) δ 25.1, 25.5, 29.0, 29.8, 43.5, 57.3, 67.5, 78.0, 127.2, 128.4, 128.6, 132.0,133.4, 135.0, 167.6, 170.5; HRMS (FAB, NBA) calcd for C₂₂H₂₆NO₄:368.1862 (M⁺ + 1). 368.1870.

HPLC analysis using CHIRALPAK AD and hexane/ i PrOH (90 : 10, 1.0mL/min), Retenti on time for (2R, 3R) : 25.2 min, for (2S,3S) : 28.9 min.

[0247]

R = cyclohexyl

Mp 125 - 127 °C; IR (KBr) 3403, 2929, 2849, 1742, 1647, 1521, 1483, 1211 cm⁻¹; 1 H NMR(400 MHz, CDCl₃) δ 0.95 - 1.78 (m, 10 H, cyclohexyl - CH₂), 1.99 (d, J = 12.1 Hz, 1H, CHC(OH) CHNH), 2.78 (d, J = 8.8 Hz, 1H, CHOH), 3.66 (dt, J = 3.2, 8.8 Hz, 1H, CHOH), 4.99 (dd, J = 2.9, 7.3 Hz, 1H, CHNH), 5.18 (d, J = 12.2 Hz, 1H, CH₂Ph), 5.34 (d, J = 12.2 Hz, 1H, CH₂Ph), 7.17 (d, J = 6.8 Hz, 1H, CHNH), 7.32 - 7.56 (m, 8H, Ar - H), 7.81 - 7.83 (m, 2H, Ar - H); 13 CNMR (100 MHz, CDCl₃) δ 25.6, 26.1, 29.0, 29.2, 40.9, 55.7, 67.5, 77.9, 127.2, 128.5, 128.6, 131.9,133.5, 135.0, 167.4, 170.8 HRMS (FAB, NBA) calcd for C_{23} H₂₈NO₄:382.2018 (M⁺ + 1). Found: 382.



1993.

HPLC analysis using CHIRALPAK AD and hexane/ i PrOH (90 : 10, 1.0mL/min), Retenti on time for (2R, 3R) : 18.7 min, for (2S,3S) : 32.2 min.

[0248]

R = cycloheptyl

[α] $_{0}^{25}$ + 12.9 (1.00, CHCl₃); IR (neat) 3418, 3064, 3033, 2925, 2854, 1734, 1646, 1539, 1190, 1082 cm⁻¹; ¹HNMR (400 MHz, CDCl₃) δ 1.24 - 1.64 (m, 11H, cyclohept yl - H), 1.76 - 1.89 (m, 2H, cycloheptyl - H), 2.79 (dd, J = 5.6, 8.4 Hz, 1H, CHO H), 3.70 (dt, J = 3.2, 8.8 Hz, 1H, CHOH), 5.01 (dd, J = 3.2, 7.2 Hz, 1H, CHNH), 5. 18 (d, J = 12.0 Hz, 1H, CH₂Ph), 5.32 (d, J = 12.0 Hz, 1H, CH₂Ph), 7.13 (d, J = 7.0 Hz, CHNH), 7.32 - 7.40 (m, 5H, Ar - H), 7.42 - 7.46 (m, 2H, Ar - H), 7.51 - 7.55 (m, 1H, Ar - H), 7.80 - 7.82 (m, 2H, Ar - H); ¹³C NMR (100 MHz, CDCl₃) δ 26.1, 26.2, 28.2, 28.9, 30.6, 42.3, 55.8, 67.5, 77.6, 127.2, 128.5, 128.6, 131.9, 133. 5, 135.0, 167.4, 170.9; HRMS (FAB, NBA) calcd for C₂₄H₃₀NO₄:396.2175 (M⁺ + 1). F ound: 396.2195.

HPLC analysis using CHIRALCEL OD-H and hexane/ PrOH (90: 10,0.5 mL/min), Retention time for (2R, 3R): 30.5 min, for (2S,3S): 34.7 min.

[0249]

実施例33-43

基質を参考例1で製造した2-シクロヘキシル-1-メトキシカルボニル-2-オキソーエチル-アンモニウム;クロリドに変え、種々反応条件を検討した。

[0250]

転化率は、反応液をHPLCで分析し、基質と生成物のピーク面積を以下の式に当ては めることにより算出した値を意味する。尚、式中の、4.37という数字は、測定波長におけ る基質と生成物の感度比を補正するために用いた値である。

転化率=生成物の面積/(生成物の面積+基質の面積/4.37)×100

[0251]

転化率の分析条件

分析方法:HPLC(島津LC10Avp)、逆相アイソクラチック分析

カラム:L-column ODS (化学物質評価技術研究機構) φ 4.6mm×250mm + CAPCELLPAKSCX UG8 0 (株式会社 資生堂) φ 4.6mm×250mm

移動相: MeCN / 100mM KH₂PO₄ 緩衝溶液 =2 / 8 (v/v)

流速:1.0ml/min.

検出:UV215nm

保持時間:基質 21.8min、生成物 23.4min.

[0252]

eeは、生成物をベンゾイル化した化合物をHPLCで分析することにより決定した。 eeの分析条件

分析方法:HPLC(島津LC10Avp)、順相アイソクラチック分析

カラム: CHIRALCEL OD-H (ダイセル化学工業株式会社)

移動相:n-Hexane / イソプロピルアルコール = 85/15 (v/v)

流速:0.5ml/min.

検出:UV254nm

保持時間: R体 11.2min、S体 15.3min.

[0253]

【化37】

[0254]



表8

実施例	圧力	 反応温度		媒	転化率	e e	立体
No.	(kgf.cm ⁻²)	(℃)	mol%	立体	(%)	(%)	(Ror S)
3 3	3 0	5 0	4	S	9 5	_	_
3 4	3 0	5 0	4	R	98	95.3	R
3 5	2 0	5 0	4	R	9 5	96.8	R
3 6	1 0	5 0	4	R	9 0	97.1	R
3 7	3 0	9 0	5	S	99	95.1	S
.3 8	3 0	7 0	5	S	98	95.2	S
3 9	3 0	5 0	5	S	9 7	96.4	S
4 0	3 0	5 0	5	S	98	96.7	S
4 1	3 0	5 0	0.5	R	9 2	94.8	R
4 2	3 0	5 0	0.1	R	9 0	82.6	R
4 3	3 0	5 0	0.01	R	8 4		_

[0255]

実施例44 [Ir(cod)Cl]2-(S)-MeO-Biphep-NaIを触媒とする製造法。

[0256]

【化38】

Ph NH₃*CF 2) Prood, Etyn, ThF

Ph CO₂Ma

[0257]

[Ir(cod)C1]2(2.5mg, 0.0037mmol)、(S)-MeO-Biphep(5.8mg, 0.01mmol)及びョウ化ナトリウム(2.3mg, 0.015mmol)を塩化メチレン(1.0mL)に加えた溶液を凍結融解法(freeze-thaw method)により脱気した。溶液をアルゴン雰囲気下、室温で、10分攪拌した。得られた黄色の触媒を真空下乾燥した。該触媒に参考例23で製造した6g(57.4mg, 0.25mmol)、酢酸ナトリウム(20.5mg, 0.25mmol)及び脱気した酢酸(1.2mL)をアルゴン雰囲気下で加えた。混合溶液を室温下、水素圧100気圧で攪拌した。24時間攪拌した後、反応溶液を1mol/L塩酸(3.0mL)に加え、ジエチルエーテル5mLで洗浄した。得られた水層を40℃以下で減圧下濃縮乾固し、残査に無水エタノールを加えて粉砕した。白色固体を濾去し、得られた透明の濾液は減圧下濃縮した。残査をテトラヒドロフラン(3mL)に溶解し、ベンゾイルクロリド(35.2mg, 0.25mmol)及びトリエチルアミン(75.9mg, 0.75mmol)を0℃にて加えた。室温で1時間攪拌した後、水及び酢酸エチル(10mL)を加えた。有機層を、1mol/L塩酸(5mL)、飽和重曹水(5mL)、飽和食塩水で順次洗浄し、無水硫酸ナトリウムにて乾燥し、沈殿物を濾去した後、減圧下濃縮した。残査をシリカゲルカラムクロマトグラフィー(20g,酢酸エチル:n-ヘキサン=1:2)に付し、N-ベンゾイル体(57.8mg, 0.19mmol, 77%, >99%de, 89.6%ee)を無色固体として得た。

[0258]

¹H-NMR (400 MHz CDCl₃) δ; 3.79(3H, s), 4.56 (1H, d, J = 5.6 Hz), 5.24(1H, dd, J = 3.6, 6.8 Hz), 5.40 (1H, dd, J = 3.6, 5.6 Hz), 6.87 (1H, brd), $7.2 \sim 7.4$ (5H, m, Ar -H), $7.4 \sim 7.5$ (2H, m, Ar-H), $7.5 \sim 7.6$ (1H, m, Ar-H), $7.7 \sim 7.8$ (2H, m, Ar-H); ¹³C-NMR (100 M Hz, CDCl₃) δ (ppm) 52.6, 59.4, 75.1, 125.9, 127.1, 128.0, 128.3, 128.6, 132.1, 133.0, 139.1; FT-IR, max (KBr): 3338, 1744, 1644, 1525, 1229, 1173, 693.; FABMS (NBA) m/z: 300 (M+1); HPLC analysis using CHIRALCEL OD-H and hexane -iPr OH (85: 15, 1.0 ml / min), Retention time for (2R, 3R): 8.6 min, for (2S, 3S): 12.0 min

【0259】 実施例45-49



添加物 (ヨウ素化合物)、酢酸塩、温度及び反応時間を変更した以外は実施例 4 4 と同様の操作を行うことにより、目的物を製造した。収率は 2 ステップの合計で示した。

尚、触媒の使用量は、基質に対してイリジウムの使用量として3 mol%であり、(S)-MeO-Biphepの使用量は、イリジウムの使用量に対して1.33当量(4/3)である。

又、表中、ヨウ素化合物の量は、イリジウムの使用量に対する当量数を表し、酢酸塩の量は、基質に対する当量数を表し、TBAIは、ヨウ化テトラn-ブチルアンモニウムを意味する。

[0260]

【化39】

Ph NH3*CT 2) PhCOO, B3N, THF Ph NHCOPh

[0261]

表 9

実施例 No.	<u>ヨウ素</u> 種類	<u>化合物</u> 量		量	温度 (℃)	時間 (h)	収率 (%)	d e (%)	e e (%)
4 5		0	Ac0Na	1	室温	3	7 9	> 9 9	7 7
4 6	TBAI	2	Ac0Na	1	室温	2 4	77	> 9 9	8 7
4 7	ΚI	2	AcOK	1	室温	2 4	5 7	96	8 7
4 8	NaI	2	Ac0Na	1	4 0	2 4	79	96	8 7
4 9	TBAI	1.1	Ac0Na	1	室温	2 4	8 3	> 9 9	8 7

[0262]

実施例 4 9 - 5 6

基質、添加物 (ヨウ素化合物)、温度及び反応時間を変更した以外は実施例 4 4 と同様の操作を行うことにより、目的物を製造した。収率は 2 ステップの合計で示した。

尚、基質の使用量:イリジウムの使用量:(S)-MeO-Biphepの使用量:添加物(ヨウ素化合物)の使用量=100:3:4:6であり、酢酸塩(酢酸ナトリウム)は、基質に対して1当量使用した。

表中、OBnはベンジルオキシを、Phはフェニルを、Meはメチルを、 β -Napは β -ナフチルを意味する。

[0263]

【化40】

R NH3*CT 2) Phocos, Elsk, The

B CO-We

[0264]

表10

-	実施例 N o .	R ∃	ウ素化合物 種類	温度 (℃)	時間 (h)	収率 (%)	d e (%)	e e (%)
-	4 9	p-OBn-Ph	TBAI	室温	4 8	5 1		9 0
	5 0	p-Me-Ph	TBAI	室温	48	6 4	> 9 9	8 6
	5 1	p-OBn-Ph	NaI	3 0	96	64		93
	5 2	p-Me-Ph	NaI	3 0	96	76	> 9 9	9 4
	5 3	m-Me-Ph	NaI	3 0	96	93	> 9 9	8 7
	5 4	β-Nap	NaI	3 0	96	9 5	9 7	8 6
	5 5	p-Br-Ph	NaI	3 0	96	8 7	> 9 9	7 5
	5 6	i-Pr	NaI	3 0	96	5 0	> 9 9	8 2



[0265]

実施例57-74

実施例44の配位子を(s)-BINAPに変更し、種々条件を変えて目的化合物を製造した。 収率は2ステップの合計で示した。

尚、基質の使用量:イリジウムの使用量:(s)-BINAPの使用量=100:3:4である

表中、添加物の量は、イリジウムの使用量に対する当量数を表し、酢酸塩の量は、基質に対する当量数を表し、又、溶媒の種類は、以下の記号を意味する。

- A エタノール
- B n-プロパノール
- C i-プロパノール
- D メタノール:ベンゼン=1:2
- E n- \mathcal{C} \mathcal{C}
- F i-プロパノール:酢酸=1:1
- G テトラヒドロフラン:酢酸=1:1
- H 酢酸

又、Phtaは、フタルイミドを意味し、TBABは、臭化テトラn-ブチルアンモニウムを意味する。

【0266】 【化41】

Ph CO₂Me
11 (cod)Cl₂ (s) BINAP
Ph NH₃*CF
2) PROCI, EM, THF

OH
Ph CO₂Me
NHCOPh

表11

実施例	溶媒	<u>添加物</u>	勿		<u> </u>	圧力	時間	収率	d e	e e
No.		種類	量	種類	量	atm	(h)	(%)	(%)	(%)
5 7			0		0	100	48	87	86	41
5 8	В		Õ		0	50	48	84	88	50
5 9	Č		0		Ō	100	48	83	88	58
6 0	Ď		0		0	50	48	81		40
6 1	Ē		0		0	100	48	37	92	66
6 2	H		0	AcONa	1	100	48	83	98	69
6 3	H		0	AcONa	1	100	48	79	>99	69
6 4	H		0	AcONa	1	100	3	90	>99	69
6 5	H		0	AcONH ₄	1.1	100	3	66	98	68
6 6	Н		0	AcOLi	1.1	100	3	58	>99	69
6 7	H		0	Ac0Na	3	100	3	79	96	68
6 8	\mathbf{F}		0	Ac0Na	1	100	48	58	86	57
6 9	G		0	Ac0Na	1	100	48	57	97	54
7 0	Н	Phta	2	AcONa	1	100	3	79	>99	69
7 1	Н	TBAI	2	AcONa	. 1	100	3	32	>99	78
7 2	H	TBAI	2	AcONa	1	100	12	65	>99	79
7 3	Н	TBAI	2	AcONa	1	100	24	70	>99	79
7 4	H	TBAB	2	AcONa	1	100	24	65	>99	75

^{[0267].}

配位子を(S)-T-BINAPに変えた以外は、実施例 6 4 と同様の操作を行うことにより目的 出証特 2 0 0 4 - 3 0 7 5 0 0 9

実施例75



物を得た。(収率:85%(2ステップ合計)、de:>99%、ee:71%) 【産業上の利用可能性】

[0268]

本発明により、医・農薬の中間体として有用である光学活性 β ーヒドロキシー α ーアミノカルボン酸誘導体のアンチ体を効率的に製造することができる。



【書類名】要約書

【要約】

【課題】 医・農薬の中間体として有用である光学活性 β ーヒドロキシー α ーアミノカルボン酸誘導体のアンチ体の効率的な製造方法を提供する。

【解決手段】 式(1)

【化1】

[式中、 R^1 は、置換若しくは無置換の C_{1-20} アルキル基又は置換若しくは無置換の C_{4-12} 芳香族基を意味し、 R^2 は、置換若しくは無置換の C_{1-20} アルキル基又は置換若しくは無置換の C_{4-12} 芳香族基を意味する。]で表される $\alpha-$ アミノアシル酢酸エステル化合物を、酸の存在下、触媒的不斉水素化反応により水素化することを特徴とする、式(2)又は式(3)

【化2】

[式中、 R^1 及び R^2 は、前記と同じ意味を示す。] で表される光学活性 β ーヒドロキシー α ーアミノカルボン酸誘導体の製造方法。

【選択図】 なし



特願2003-426226

出願人履歴情報

識別番号

[000003986]

1. 変更年月日 [変更理由]

1990年 8月29日

更埋田」 住 所 新規登録 東京都千代田区神田錦町3丁目7番地1

氏 名 日産化学工業株式会社